

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 9 月 29 日 (29.09.2005)

PCT

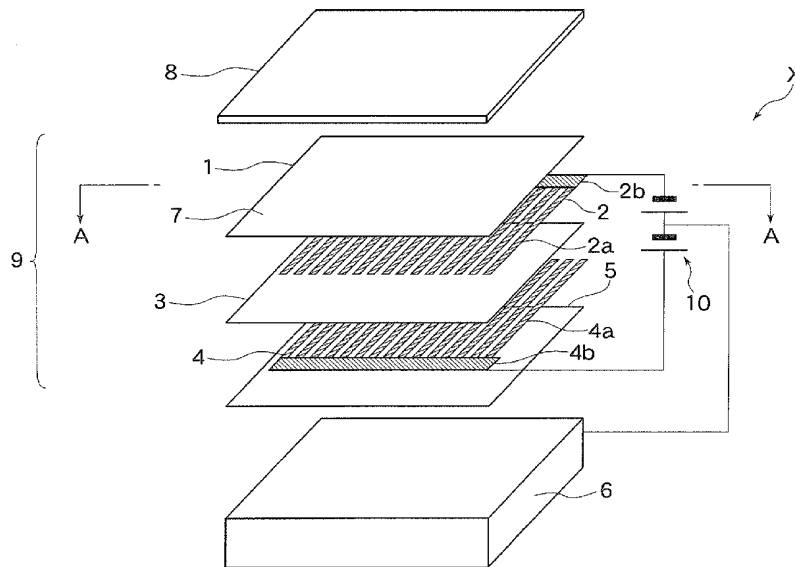
(10) 国際公開番号
WO 2005/091356 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/68, H02N 13/00 都千代田区麹町 1-8-1 4 麹町 Y K ビル 5 F Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/004557
- (22) 国際出願日: 2005 年 3 月 15 日 (15.03.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-081432 2004 年 3 月 19 日 (19.03.2004) JP
特願2004-191280 2004 年 6 月 29 日 (29.06.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社クリエイティブテクノロジー (CREATIVE TECHNOLOGY CORPORATION) [JP/JP]; 〒1020083 東京
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤澤 博 (FUJISAWA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒6308301 奈良県奈良市高畑町 5 3 7-7 Nara (JP). 宮下 欣也 (MIYASHITA, Kinya) [JP/JP]; 〒1020083 東京都千代田区麹町 1-8-1 4 麹町 Y K ビル 5 F、株式会社クリエイティブテクノロジー内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 成瀬 勝夫, 外 (NARUSE, Katsuo et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋 2 丁目 1 1 番 5 号 T K K 西新橋ビル 5 階 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: BIPOLAR ELECTROSTATIC CHUCK

(54) 発明の名称: 双極型静電チャック



(57) Abstract: A bipolar electrostatic chuck which has excellent dielectric breakdown strength and provides excellent attracting performance. The bipolar electrostatic chuck eliminates difficulty in peeling off a sample from a sample attracting plane as much as possible after application of a voltage to electrodes is finished. The bipolar electrostatic chuck is provided with a first electrode and a second electrode in an insulator and permits a surface of the insulator to be the sample attracting plane. The insulator has the first electrode, an interelectrode insulating layer and the second electrode in this order from the sample attracting plane in the depth direction. The second electrode has a region not overlapping with the first electrode in a normal line direction of the sample attracting plane.

(57) 要約: 絶縁耐性に優れ、かつ、優れた吸着力を発揮する双極型静電チャックを提供する。また、電極への電圧の印加を終えた後、試料吸着面からの試料のはがし取りにくさを可及的に解消できる双極型静電チャックを提供する。 絶

[続葉有]

WO 2005/091356 A1



(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

縁体の内部に第一電極と第二電極とを備えてこの絶縁体の表面を試料吸着面とする双極型の静電チャックであり、上記絶縁体はその深さ方向に試料吸着面から近い順に第一電極、電極間絶縁層、及び第二電極を有し、この第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極に対して非重量領域を有する双極型静電チャックである。

明 細 書

双極型静電チャック

技術分野

[0001] この発明は、静電的に試料を吸着保持する双極型静電チャックに関する。

背景技術

[0002] エッチング装置、化学気相蒸着(CVD)による薄膜形成などに用いるプラズマ処理装置、電子露光装置、イオン描写装置、イオン注入装置など、シリコン等の半導体ウエハに集積回路を形成する際に必要な半導体製造プロセスで使用される装置をはじめ、ガラス等の絶縁性基板に液晶の圧入を行う際に用いる基板張り合わせ装置、イオンドーピング装置など、テレビ画面やコンピュータ用ディスプレイ等に使用される液晶ディスプレイパネルの製造工程で使用される装置では、ウエハやガラス等の試料を静電的に吸着保持する静電チャックが広く用いられている。これは、機械的機構を利用した保持と比較して、試料の損傷の問題、機械的接触による傷等から発生するパーティクルが引き起こす歩留まりの問題、更には保持した試料の平坦性の補償等において静電チャックが優れた性能を発揮するためである。

[0003] 近年、大型液晶テレビの普及やフラットパネルディスプレイの開発等を受けて、これまでより大型のガラス基板を処理する必要性が生じ、なかでは大型のものとして1m×1mを超える基板を用いた製品も製造されている。また、半導体製造工程においては、直径300mmのシリコンウエハの処理が現在の主流となってきている。いずれの場合も大型化が進み、ガラス基板や半導体ウエハの重量が増すことにも関係して、高い吸着力と共に、静電チャックに吸着された際の吸着面での試料の平坦性がより重要になっている。

[0004] 一般に、静電チャックに吸着された試料の吸着面での平坦性は、静電チャックが試料を保持する保持力の大きさにも関係してくる。すなわち、上記のように吸着する試料の大型化が進むにつれ、静電チャックが十分な保持力を有さなければならない。

ここで、2つの電極に正負の電圧を印加する双極型の静電チャックでは、下記式(1)で示されるような、不均一な電界の場合に発生するグラディエント力Fの働きによっ

でシリコン等の半導体ウエハやガラス基板等の誘電体を吸着すると考えられており、このグラディエント力は電界強度 E の2乗の空間微分、すなわちグラディエントに比例する。

$$F \propto \nabla (E^2) \dots \dots (1)$$

[0005] そこで、これまでに互いに隣接する電極間の距離を狭めた双極型の静電チャックがいくつか報告されている。例えば、互いに帯状くし歯の形状をした電極を互い違いに入り組ませて10cm×10cmの一層櫛型双極電極を形成し、かつ、これらの互いの電極を1mmピッチ(それぞれの電極幅が1mmであり、かつ、互いの電極間隔が1mm)で配列すると共に、表面誘電体層を50 μ mとした双極型の静電チャックが報告されている(K.Asano, F.Hatakeyama and K. Yatsuzuka, 「Fundamental Study of an Electrostatic Chuck for Silicon Wafer Handling」, IAS '97. Conference Record of the 1997 IEEE Industry Applications Conference Thirty-Second IAS Annual Meeting (Cat. No.97CH36096), Part: vol.3 , Page: 1998-2003.)。そして、この静電チャックでは、被吸着物であるシリコンウエハに対して印加電圧1500Vで \sim 3Nの吸着力を得ている。これは単位面積あたりの吸着力に換算すると \sim 3gf/cm²となる。また、絶縁体の内部に対になった帯状電極を備えた双極型の静電チャックにおいて、その帯状電極の線幅及び帯状電極間をそれぞれ0.3 \sim 3mmとした例も報告されている(特開平10-223742号公報)。更には、誘電性のベース上に間隔が離れた電極を配列し、これら電極の電極幅及び電極間隔をそれぞれ100 μ m以下とする例も報告されている(特表2000-502509号公報)。

[0006] しかしながら、互いに隣接する電極間距離を狭めた場合には放電限界が問題となる。すなわち、静電チャックに用いる電極材のエッチング断面の制御や、絶縁体の内部で電極を固定する接着層の形成具合の制御等が難しいため、例えば従来の双極型静電チャックの断面図を示した図28の電極付近の断面模式図(拡大図)のように、第一電極2及び第二電極4の端部のエッチング不揃いによる尖った個所には電界が集中し易く、また、絶縁層どうし、あるいは絶縁層と電極とを固定する接着層を形成するための接着剤が固着する際にボイドが生じるため、隣接する電極間では絶縁耐圧が著しく低下する。そのため、上記のような双極型の静電チャックでは、電極と電極と

の間がある一定距離に近づくと、電極間で放電を起こすおそれがある。

[0007] この放電限界については、一般に、双極型の静電チャックでは、電極間の距離が0.5mmに対して3kV程度であるとされている。実際には、上記のような双極型静電チャックを使用する際には、安全率をみてこれより低い電圧を印加するようにしなければならない。そのため、先に説明したような従来の電極間幅を狭めた双極型の静電チャックでは、実際に印加できる電圧は制限されてしまい、直径サイズの大型化が進む半導体ウエハや、大型化が進む液晶テレビやフラットパネルディスプレイ等に使用されるガラス基板に対しては、単位面積当たりの重量が増加するため十分な吸着力(グラディエント力)を発揮することができないといった問題がある。

[0008] 一方、絶縁性の試料を静電チャックに吸着させた場合、電極に印加する電圧を切っても残留電荷によって静電チャックの試料吸着面から試料がはがれにくいといった問題があり、特に、上記のように試料の大型化が進むと、この問題はより深刻となる。

[0009] ところで、双極型の静電チャックについては、先に説明したものを含めて電極を同一平面となるように配設したものほとんどであり、なかには絶縁体の内部に複数の電極を積層するタイプの静電チャックも報告されているが(特許第2838810号公報)、極性の異なる電極を同一平面内に配設する点で上記双極型静電チャックと同じであり、同様に放電限界の問題を抱える。

特許文献1:特開平10-223742号公報

特許文献2:特表2000-502509号公報

特許文献3:特許第2838810号公報

非特許文献1:K.Asano, F.Hatakeyama and K. Yatsuzuka, 「Fundamental Study of an Electrostatic Chuck for Silicon Wafer Handling」, IAS '97. Conference Record of the 1997 IEEE Industry Applications Conference Thirty-Second IAS Annual Meeting (Cat. No.97CH36096), Part: vol.3 , Page: 1998-2003.

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0010] そこで、本発明者らは、上述したような従来の双極型静電チャックの放電限界が電界強度にして6MV/m程度であることに注目した。この値は一般に経験的に知られ

ている真空中の絶縁破壊電界強度 $10\text{MV}/\text{m}$ より低く、また、絶縁体の材質の耐圧、例えばポリイミドでは $160\text{MV}/\text{m}$ に比べて圧倒的に低いことから、絶縁体の内部で隣接する、互いに異なる極性の電圧を印加する電極の間では、隣接する電極端部の形状やこれらの電極の間に存在する接着層内のボイド等が絶縁破壊電界強度の低下に大きく影響を与えているという考えに至った。

そして、電界強度に優れ、かつ、大型の試料であっても十分に対応可能な強いグラディエント力を発揮する双極型静電チャックの実現について鋭意検討した結果、異なる極性の電圧を印加する第一の電極と第二の電極とを絶縁体の内部に試料吸着面から深さ方向に向かって順に並べると共に、これらの電極の間には絶縁耐圧に優れた絶縁層を配設することによって、これらの電極の電極間距離を狭めて強いグラディエント力を発現せしめても絶縁耐性に優れることを見出し、本発明を完成した。

[0011] 従って、本発明の目的は、絶縁耐性に優れ、かつ、優れた吸着力を発揮する双極型静電チャックを提供することにある。

また、本発明の別の目的は、電極への電圧の印加を終えた後、試料吸着面からの試料のはがし取りにくさを可及的に解消できる双極型静電チャックを提供することにある。

課題を解決するための手段

[0012] すなわち、本発明は、絶縁体の内部に第一電極と第二電極とを備えてこの絶縁体の表面を試料吸着面とする双極型の静電チャックであり、上記絶縁体はその深さ方向に試料吸着面から近い順に第一電極、電極間絶縁層、及び第二電極を有し、この第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極に対して非重畳領域を有することを特徴とする双極型静電チャックである。

また、本発明は、上記絶縁体の表面に更に導電性層を形成し、この導電性層の表面を試料吸着面とする双極型静電チャックである。

[0013] 本発明においては、絶縁体はその深さ方向に試料吸着面から近い順に第一電極、電極間絶縁層、及び第二電極とを有し、この第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極に対して非重畳領域を有する必要がある。第一電極と第二電極は絶縁体の内部において絶縁体の深さ方向(厚み方向)に互いに離れて存在すると共に、こ

の第一電極と第二電極との間には電極間絶縁層が存在する必要がある。

- [0014] 本発明において、第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極に対して非重畳領域を有するとは、絶縁体の内部に存在する第一電極と第二電極のみを対象として試料吸着面から垂直方向にみた場合、第二電極が第一電極とは重ならない領域を有することを言う。具体的には、第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極と重ならない場合と、第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に第一電極と重なる場合(この重なる部分以外は第二電極が第一電極とは重ならない)とがある。ここで、第一電極と第二電極とが試料吸着面の法線方向に互いに線で接する場合、及び第一電極と第二電極とが試料吸着面の法線方向に互いに点で接する場合については、後者の具体例、すなわち、第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に第一電極と重なる場合に含めるとする。
- [0015] 本発明における第一電極及び第二電極のそれぞれの形状、及び絶縁体の内部における両電極の配置については、上述したように第二電極が試料吸着面の法線方向に上記第一電極に対して非重畳領域を有することができればよく、例えば、以下のような場合を挙げることができる。
- [0016] すなわち、第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極と重ならない場合として、例えば、第一電極が帯状くし歯に形成されると共に第二電極が帯状くし歯に形成され、これら2つの帯状くし歯が互い違いに入り組まれて第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極と重ならないように配置してもよく、第一電極が半円状に形成されると共に第二電極が第一電極と線対称な半円状に形成され、第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極と重ならないように配置してもよく、第一電極が長方形又は正形状に形成されると共に第二電極が第一電極と線対称な長方形又は正形状に形成され、第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極と重ならないように配置してもよい。
- [0017] 第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に第一電極と重なる場合として、例えば、第一電極が帯状くし歯に形成されると共に第二電極が所定の領域を有する平板状に形成され、この第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に上記第一電極と重なるように配置してもよい。また、第一電極が井桁状に形成されると共に第二電極が所

定の領域を有する平板状に形成され、この第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に上記第一電極と重なるように配置してもよい。

また、第一電極が所定の領域内に円形、三角形、正方形、長方形、又は四角形以上の多角形の形状をした開口部を複数有したメッシュ状に形成されると共に第二電極が所定の領域を有する平板状に形成され、この第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に上記第一電極と重なるように配置してもよい。第一電極における開口部の大きさ(円については直径、四角形以上では対角線の長さ)については、隣接する開口部との距離と同程度か、あるいは隣接する開口部と開口部との距離の120%程度となるように形成するのがよく、第一電極をこのような大きさの開口部を有するメッシュ状にすることにより、第二電極からの電界の漏れを適度に多くすることができる。この開口部の具体的な大きさについては、十分なグラディエント力を発揮せしめる観点から、好ましくは0.1〜3.0mmであるのがよい。更には、吸着力の均一性の観点から、開口部については好ましくは第一電極の所定の領域内に均一に存在しているのがよい。

[0018] また、第一電極が所定の幅を有するリング状に形成されると共に第二電極が所定の円形領域を有する平板状に形成され、この第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に上記第一電極と重なるように配置してもよい。また、第一電極が、所定の円形領域を有する円形部を中心にしてこの円形部から所定の間隔をおいて同心円状に並ぶ第一環状部を有し、かつ、上記円形部と第一環状部とを結ぶ第一接続部を有するように形成され、第二電極が、上記第一電極の円形部と第一環状部との間隔より小さい幅を有する環状に形成され、この第二電極が試料吸着面の法線方向にみて上記第一電極の円形部と第一環状部との間に配置されてもよく、また、第一電極が、所定の円形領域を有する円形部を中心にしてこの円形部から所定の間隔をおいて同心円状に並ぶ第一環状部を有し、かつ、上記円形部と第一環状部とを結ぶ第一接続部を有するように形成され、第二電極が、上記第一電極の円形部と第一環状部との間隔と同じ幅を有する環状に形成され、この第二電極が試料吸着面の法線方向にみて上記第一電極の円形部と第一環状部との間に配置されてもよい。上述したように、第一電極が円形部と第一環状部と第一接続部を有すると共に第二電極が環状

に形成される場合、第一電極と第二電極とがそれぞれ複数の同心円状の環状部を有するように形成してもよい。すなわち、第一電極が、互いに所定の間隔において同心円状に並ぶ2つ以上の第一環状部を有し、一方、第二電極が、互いに所定の間隔において同心円状に並ぶ2つ以上の第二環状部を有し、かつ、第二環状部の間を結ぶ第二接続部を有するように形成され、第二電極の各第二環状部が試料吸着面の法線方向にみて上記第一電極の各第一環状部の間に配置されてもよい。

[0019] 更には、第一電極と第二電極とが、上記で説明したいずれかの形状に各々形成され、この第一電極と第二電極とを組み合わせ配置し、第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に第一電極と重なるように配置してもよい。

[0020] 本発明における第一電極及び第二電極については、例えば互いに極性の異なる電圧を印加したり、あるいは一方の電極をGround(接地)にして残りの電極をプラス極又はマイナス極とするなどして、互いに電位差を生じさせるようにする。この第一電極については1又は2以上の電極から形成してもよく、第二電極についても1又は2以上の電極から形成するようにしてもよい。

[0021] 本発明においては、試料吸着面に保持される試料への吸着力の均一性の観点から、好ましくは第一電極と第二電極のそれぞれの外周形状が占める領域が、共に試料吸着面の中央部から周縁部に至るまでの領域を占めることができるのがよい。すなわち、第一電極の外周形状と第二電極の外周形状とが試料吸着面の法線方向に対し互いに略重なるのが好ましい。更に好ましくは第一電極の外周形状と第二電極の外周形状と試料吸着面に保持される試料の外周形状とが試料吸着面の法線方向に対して互いに略重なるのがよい。

また、第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極に対して有する非重畳領域については、吸着力の均一性の観点から、好ましくは試料吸着面の中央部から周縁部に至るまでの領域に均一に存在しているのがよく、更に好ましくは上記非重畳領域が存在する領域が、試料吸着面に吸着される試料が占める領域に均一に存在しているのがよい。

[0022] 一方、静電チャックの静電容量を低減することができる観点から、好ましくは上記第一電極と第二電極とが試料吸着面の法線方向に対して互いに重なる領域が少なくな

るほどよく、更に好ましくは第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極と重ならないのがよい。静電チャックの静電容量を低減することができれば、両電極への電圧の印加を終えた後に試料吸着面からの試料のはがし取りにくさを可及的に解消することができる。

[0023] 本発明において、絶縁体の内部における第一電極と第二電極との電極間距離については $1\sim 1000\mu\text{m}$ 、好ましくは $50\sim 500\mu\text{m}$ であるのがよい。第一電極と第二電極との電極間距離が $1\mu\text{m}$ より小さいと、例えば第一電極、電極間絶縁層及び第二電極を市販されている積層体を利用して形成する場合、すなわち、絶縁性フィルムの表裏両面に金属箔を有するような積層体を用いる場合、電極間絶縁層を形成する絶縁性フィルムが $1\mu\text{m}$ より薄いものを市場にて入手するのが困難であり、反対に、上記電極間距離が $1000\mu\text{m}$ より大きくなると、得られた双極型静電チャックが熱伝導性の観点で問題が生じるおそれがある。また、上記電極間距離が $50\mu\text{m}$ 以上であれば市販のポリイミド等の絶縁シートを用いて接着剤により積層して電極間絶縁層を形成することで必要な電極間距離を容易に形成することができ、また、 $500\mu\text{m}$ 以下であれば市場にて入手可能な1枚の絶縁シートの厚さを厚く設定して電極間絶縁層を形成して必要な電極間距離を容易に形成することができると共に、得られた静電チャックが数kV程度の低電圧動作によって必要な吸着力を発現せしめることができるようになる。尚、上記電極間距離とは、第一電極と第二電極との間を直線で結ぶ最短距離を言う。

[0024] また、本発明において第一電極を帯状くし歯に形成する場合、この帯状くし歯の帯状部分の幅(以下、「帯状電極幅」と言うこともある)と隣り合う帯状部分との間隔(以下、「電極間隙間」と言うこともある)とを等しくしたとき(帯状電極幅＝電極間隙間＝ z とする)、この z については好ましくは $0.15\sim 0.5\text{mm}$ の範囲内であるのがよく、更に好ましくは $0.2\sim 0.4\text{mm}$ であるのがよい。帯状電極幅と電極間隙間とを等しくしてこれらを上記範囲内にすることで優れた吸着力を発揮する。

[0025] 本発明における第一電極と第二電極については、例えば銅、タングステン、アルミニウム、ニッケル、クロム、銀、白金、錫、モリブデン、マグネシウム、パラジウム等から形成することができ、電導性あるいは生産性の観点から好ましくは銅、アルミニウムで

あるのがよい。また、第一電極と第二電極とは同じ材質から形成してもよく、互いに異なる材質から形成してもよい。

そして、第一電極及び第二電極については、絶縁性フィルムの表裏両面に上記のような金属からなる箔を有した市販の積層体を利用することも可能である。あるいは、例えば電極間絶縁層の上面及び下面、あるいは後述する上部絶縁層又は下部絶縁層におけるそれぞれの一方の面に通常のスパッタ法を用いて上記金属からなる電極面を形成し、次いで形成した電極面を通常のエッチング方法を用いてそれぞれ所定の形状にしてもよい。また、銅、タングステン、アルミニウム、ニッケル、クロム、銀、白金、錫、モリブデン、マグネシウム、及びパラジウムから選ばれた1以上の金属をペースト状にして印刷処理を用いてもよく、イオンプレーティング蒸着法を用いた処理、メッキ処理、気相成長法で成膜の後に所定のパターンにエッチングする方法、モリブデン、タングステン、タンタル等の高融点金属を用いた溶射を用いる方法等の手段により電極間絶縁層、或は後述する上部絶縁層や下部絶縁層の表面に形成するようにしてもよい。

[0026] 第一電極と第二電極のそれぞれの厚みについて、絶縁性フィルムの表裏両面に金属箔を有した積層体を利用する場合には、両電極共に $0.2\sim 30\mu\text{m}$ 、好ましくは $1\sim 30\mu\text{m}$ であるのがよい。電極の厚みが $0.2\mu\text{m}$ より小さいとピンホール等が入りやすく、技術的に製作が難しく、反対に $30\mu\text{m}$ より大きくなると絶縁体の内部における電極付近にボイド等による隙間が形成されて、絶縁体としての強度に問題が生じるおそれがある。また、電極の厚みが $1\mu\text{m}$ 以上であれば、特に大型の静電チャックを形成する場合でも、信頼性のある電極を全域に形成することが可能となる。

モリブデン、タングステン、タンタル等の所定の金属で溶射して形成する場合には、第一電極については $20\sim 100\mu\text{m}$ 、好ましくは $20\sim 30\mu\text{m}$ であるのがよく、第二電極については $20\sim 100\mu\text{m}$ 、好ましくは $20\sim 30\mu\text{m}$ であるのがよい。両電極共に膜厚が $20\mu\text{m}$ より小さくなるとボイドが発生し、導電膜として機能し難くなる。

上記その他の方法で第一電極と第二電極を形成する場合においても、例えば $1\sim 30\mu\text{m}$ 程度とすることができる。

[0027] 本発明における第一電極の一部又は全部を試料吸着面の法線方向に切った断面

形状については特に制限はないが、例えば長方形、正方形、円形、三角形、四角形、又はそれ以上の多角形等から選ばれた形状を挙げることができる。また、本発明における第二電極の一部又は全部を試料吸着面の法線方向に切った断面形状についても、上記第一電極の場合と同様に考えることができ、第一電極及び第二電極の一部又は全部の断面形状を同じ形状に揃えてもよく、互いに異なる形状にしてよい。

[0028] 本発明における電極間絶縁層については、絶縁体の内部において第一電極と第二電極とが互いに接しないよう離すことができると共に、第一電極と第二電極とが電氣的に絶縁されるものであればよい。このような電極間絶縁層としては、例えばポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、エポキシ、及びアクリルから選ばれた1種又は2種以上の樹脂からなる樹脂層によって形成してもよく、酸化アルミ、窒化アルミ、炭化珪素、窒化珪素、ジルコニア及びチタニアから選ばれた1種又は2種以上からなるセラミックス層によって形成してもよく、あるいは、珪素及び二酸化珪素から選ばれた1種又は2種からなる層などによって形成してもよい。このうち、量産性の観点から、好ましくはポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート及びエポキシから選ばれた1種又は2種以上の樹脂からなる樹脂層によって形成するのがよく、耐絶縁性や化学的耐性の観点から更に好ましくはポリイミドであるのがよい。

[0029] 上記樹脂層については、好ましくは1又は2以上の樹脂フィルムからなるのがよい。このような樹脂フィルムとしては、具体的には、カプトン（東レ・デュポン社製商品名）、ユーピレックスADシート（宇部興産社製商品名）、アピカル（鐘淵化学工業社製商品名）等を挙げることができ、更に好ましくはポリイミドからなるカプトンである。電極間絶縁層を形成する樹脂層に樹脂フィルムを用いることで、第一電極と第二電極の間をボイドの存在等のおそれを可及的に排除して信頼性のある電極間絶縁層を形成でき、絶縁耐性に優れた静電チャックを得ることができる。例えばカプトン（東レ・デュポン社製商品名）の絶縁破壊電界強度は160MV/mであるとされており、このカプトンを電極間絶縁層とした本発明の静電チャックは、更に優れた絶縁耐性を発揮し得る。

[0030] この樹脂層の厚みについては、用いる材質によっても異なるが、例えばポリイミドフ

フィルムを用いる場合、 $1\sim 1000\ \mu\text{m}$ 、好ましくは $50\sim 500\ \mu\text{m}$ であるのがよい。電極間絶縁層の厚みが $1\ \mu\text{m}$ より小さいと、例えば第一電極、電極間絶縁層及び第二電極を市販されている積層体を利用して形成する場合、すなわち、絶縁性フィルムの表裏両面に金属箔を有するような積層体を用いる場合、電極間絶縁層を形成する絶縁性フィルムが $1\ \mu\text{m}$ より薄いものを市場にて入手するのが困難であり、反対に、電極間絶縁層の厚みが $1000\ \mu\text{m}$ より大きくなると、得られた双極型静電チャックが熱伝導性の観点で問題が生じるおそれがある。また、電極間絶縁層の厚みが $50\ \mu\text{m}$ 以上であれば市販のポリイミド等の絶縁シートを用いて接着剤により積層して形成することが可能であり、また、 $500\ \mu\text{m}$ 以下であれば市場にて入手可能な1枚の絶縁シートの厚さを厚く設定することにより製作可能であると共に、得られた静電チャックが数千V程度の低電圧動作によって必要な吸着力を発現せしめることができるようになる。

[0031] 電極間絶縁層をセラミックス層から形成する場合は、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化珪素、窒化珪素、ジルコニア、イットリア、マグネシア、及びチタニアの単体又はこれらの複合体を大気あるいはプラズマなどによる溶射によって形成してよく、また、焼結済みセラミックス薄板を用いて形成してもよい。

溶射によって形成する際には、電極間絶縁層の膜厚は、一般的な溶射技術によって $30\sim 500\ \mu\text{m}$ 程度の範囲で形成することができ、必要に応じて最大 3mm 程度の厚みまでは厚くすることも可能である。この膜厚が $30\ \mu\text{m}$ より小さいと均一な層が形成し難く、反対に $500\ \mu\text{m}$ より大きくなるとグラディエント力が小さくなってしまう。また、半導体装置等で使用される最中の侵食によって試料や装置等への汚染の影響を可及的に低減させる目的や、耐絶縁性に優れる観点から、好ましくは99.99%以上の純度の高いものを用いて溶射によりセラミックス層を形成するのがよく、また、試料吸着面に保持した試料を効率良く冷却させる観点から、窒化アルミニウム等の熱伝導性の高いものを用いるのが好ましい。

溶射によってセラミックス層を形成する場合は、溶射後の上面を機械加工等により平坦化するのがよい。この際の平坦度については、絶縁体内における電極の位置関係から重要であって、電界の形成を均一にしてグラディエント力による吸着力を試料吸着面において均一にする観点から、表面粗さRaを $5\sim 50\ \mu\text{m}$ 程度とするのがよく

、10 μm 以下とするのが好ましい。

[0032] 一方、焼結済みのセラミックス薄板を用いて電極間絶縁層を形成する場合は、その膜厚については任意に設計することができるが、好ましくは30～500 μm の範囲とするのがよい。この膜厚が30 μm より小さいと均一な層の形成が難しく、反対に500 μm より大きくなるとグラディエント力が小さくなってしまう。また、用いる材質については、溶射の場合と同様である。

[0033] また、電極間絶縁層を珪素及び二酸化珪素から選ばれた1種又は2種からなる層で形成する場合には、例えばCVDあるいはスパッタ法によって膜厚1～50 μm の電極間絶縁層を形成することができる。

[0034] また、本発明における絶縁体は、その深さ方向に試料吸着面から近い順に第一電極、電極間絶縁層、及び第二電極とを有する必要があるが、好ましくは絶縁体の深さ方向に試料吸着面から近い順に上部絶縁層、第一電極、電極間絶縁層、第二電極、及び下部絶縁層を有するのがよい。ここで、上部絶縁層及び下部絶縁層を示す上下の方向は、絶縁体の表面の試料吸着面側を上として試料吸着面により近い方を上部、遠い方を下部とする意味である。

[0035] この上部絶縁層については、例えば、下面に熱可塑性ポリイミドを有するポリイミド、ポリアミド、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、及びエポキシから選ばれた1種又は2種以上の樹脂からなる樹脂層、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化珪素、窒化珪素、ジルコニア、イットリア、マグネシア、及びチタニアから選ばれた1種又は2種以上からなるセラミックス層等を挙げることができ、生産性及び絶縁性の観点から好ましくは下面に熱可塑性ポリイミドを有するポリイミドであるのがよい。

また、下部絶縁層については、上面に熱可塑性ポリイミドを有するポリイミドのほか上記上部絶縁層の場合と同様であり、生産性及び絶縁性の観点から好ましくは上面に熱可塑性ポリイミドを有するポリイミドであるのがよい。

[0036] 樹脂層によって上部絶縁層を形成する場合、その膜厚については、10～200 μm 、好ましくは50～100 μm であるのがよい。上部絶縁層の膜厚が50 μm より小さいと膜の耐久性に影響が考えられ、反対に100 μm より大きくなるとグラディエント力が小さくなることが懸念される。また、樹脂層によって下部絶縁層を形成する場合の膜厚

については、 $10\ \mu\text{m}$ 以上、好ましくは $50\ \mu\text{m}$ 以上であるのがよい。上部絶縁層の膜厚が $50\ \mu\text{m}$ より小さいと耐電圧性の問題や静電容量の増加等の問題が懸念され、反対に $200\ \mu\text{m}$ より大きくなると被吸着物から基盤への熱の伝わり方が不十分となるおそれ、すなわち被吸着物の冷却が不十分となるおそれがある。

[0037] 一方、上部絶縁層及び／又は下部絶縁層をセラミックス層から形成する場合、電極間絶縁層の場合と同様に、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、炭化珪素、窒化珪素、ジルコニア、イットリア、マグネシア、及びチタニアの単体又はこれらの複合体を大気あるいはプラズマなどによる溶射によって形成することができ、また、焼結済みセラミックス薄板を用いて形成することができる。

溶射によって形成する場合、その膜厚については、上部絶縁層においては樹脂層によって形成する場合と同様の理由から好ましくは $10\ \mu\text{m}$ ～ $200\ \mu\text{m}$ であるのがよく、下部絶縁層においても同様の理由から好ましくは $10\ \mu\text{m}$ ～ $200\ \mu\text{m}$ であるのがよい。用いる材質及び平坦化については電極間絶縁層の場合と同様である。

[0038] 上部絶縁層及び／又は下部絶縁層を焼結済みのセラミックス薄板を用いて形成する場合、その膜厚については任意に設計することができ、上述した樹脂層又は溶射によって形成する場合と同様の理由から好ましくは 10 ～ $200\ \mu\text{m}$ の範囲とするのがよい。また、用いる材質については、溶射の場合と同様である。

上部絶縁層、下部絶縁層、又は電極間絶縁層のいずれか1以上をセラミックス薄板で形成する場合には、接着手段が必要となり、例えばエポキシ接着剤、ろう付け等による接着方法を用いてもよく、セラミックス薄板を高温状態に保ち、真空炉の中で圧接して接着してもよい。

[0039] また、本発明においては、絶縁体の表面に更に導電性層を形成し、この導電性層の表面を試料吸着面としてもよい。絶縁体の表面に更に導電性層を形成してこの導電性層の表面を試料吸着面とすることによって、静電チャックの時定数を低減することができ、双極型電極の両電極への電圧の印加を終えた後に試料吸着面からの試料のはがし取りにくさを可及的に解消することができる。このような導電性層は、例えば絶縁体の表面に導電性ポリイミドシートや導電性フッ素樹脂を積層したり、あるいは絶縁体自体に導電性をもたせるためにカーボン等の充填材を混合させるなどして

形成することができる。

[0040] 本発明における双極型静電チャックを作製する方法としては、例えば、先ず電極間絶縁層の上面及び下面の両面にそれぞれ上述した方法によって第一電極及び第二電極を形成する。次いで、下面に熱可塑性ポリイミドフィルムを有するポリイミドフィルムを第一電極及び第二電極を備えた電極間絶縁層の上に重ねて処理温度100〜250℃、圧力0.1〜5MPaの条件で低温熱圧着成型して上部絶縁層を形成し、更に上面に熱可塑性ポリイミドフィルムを有するポリイミドフィルムの上に、一体となった上部絶縁層、第一電極、電極間絶縁層及び第二電極を重ねて上記と同様に低温熱圧着成型して絶縁体を形成してもよい。また、上部絶縁層として下面に熱可塑性ポリイミドフィルムを有するポリイミドフィルム、上下の両表面に第一電極及び第二電極を形成した電極間絶縁層、下部絶縁層として上面に熱可塑性ポリイミドフィルムを有するポリイミドフィルムを順じ重ね、処理温度100〜250℃、圧力0.1〜5MPaの条件で一度に低温熱圧着成型して絶縁体を形成してもよい。そして、上記絶縁体を熱可塑性ポリイミドフィルムやエポキシ圧着シート等を介してアルミニウム、アルミニウム合金、MMC(メタル・マトリックス・コンポジット)、ステンレス、ステンレス合金の金属基盤や、アルミナ、窒化アルミニウム等のセラミック材等からなるセラミックス基盤に載せ、処理温度100〜250℃、圧力0.1〜5MPaの条件で低温熱圧着して静電チャックを完成することができる。

或は、ポリイミド銅張積層板である市販のユピセルN(宇部興産株式会社製商品名)やネオフレックス(三井化学株式会社製商品名)等の銅表面層を有するポリイミドシートをはじめとした絶縁フィルムの表裏両面に金属箔を有する積層体を用いて、この金属箔を所定の電極パターンにエッチングする等して第一電極、電極間絶縁層及び第二電極を形成し、これに上記と同様にして上部絶縁層及び下部絶縁層を貼付け、さらに上記と同様にして金属基盤に貼り付けて静電チャックを完成してもよい。また、これら静電チャックについては、先に説明した方法によって導電性層を形成してもよい。

発明の効果

[0041] 本発明の双極型静電チャックは、絶縁体の深さ方向に試料吸着面から近い順に第

一電極、電極間絶縁層、及び第二電極とを有する構造を採用するため、優れた絶縁耐性を備え、第一電極と第二電極の電極間距離を可及的に狭くすることが可能となり、優れた吸着力を発揮する。その結果、本発明の双極型静電チャックは、保持する試料の平坦性に優れると共に、近年の大型化に対応した1m×1mを超えるガラス基板や直径300mmあるいはそれ以上のシリコンウエハ等に対しても十分な吸着性能を発揮し、また、優れた吸着力を発現せしめることができるため、低電圧駆動が可能となり、経済性の面で有利であると共に放電の心配が可及的に解消されて信頼性も高い。

更に、本発明の双極型静電チャックは、第一電極と第二電極とが試料吸着面の法線方向に対して互いに重なる領域を可及的に少なくすることによって、静電チャックの静電容量を低減することができ、両電極への電圧の印加を終えた後に試料吸着面からの試料のはがし取りにくさを解消することができる。更にまた、絶縁体の表面に更に導電性層を形成してこの導電性層の表面を試料吸着面とした場合には、試料吸着面の法線方向に対する第一電極と第二電極との重なる領域にかかわらずに、静電チャックの時定数を低減することができ、双極型電極の両電極への電圧の印加を終えた後に試料吸着面からの試料のはがし取りにくさを解消できる。

図面の簡単な説明

[0042] [図1]図1は、本発明の実施例1に係る双極型静電チャックXの分解斜視説明図である。

[図2]図2は、実施例1に係る双極型静電チャックXの断面説明図(図1のA-A断面の一部)である。

[図3]図3は、実施例1に係る双極型静電チャックXの第一電極と第二電極とを試料吸着面の法線方向にみた一部平面説明図である。

[図4]図4は、本発明の実施例2に係る双極型静電チャックの断面説明図である。

[図5]図5は、実施例2に係る双極型静電チャックXの第一電極と第二電極とを試料吸着面の法線方向にみた一部平面説明図である。

[図6]図6は、本発明における実施例3に係る双極型静電チャックXの分解斜視説明図である。

[図7]図7は、実施例3に係る双極型静電チャックXの断面説明図(図6のA-A断面の一部)である。

[図8]図8は、実施例3に係る双極型静電チャックXの第一電極と第二電極とを試料吸着面の法線方向にみた一部平面説明図である。

[図9]図9は、本発明の実施例4に係る双極型静電チャックXの分解斜視説明図である。

[図10]図10は、実施例4に係る双極型静電チャックXの第一電極と第二電極とを試料吸着面の法線方向にみた一部平面説明図である。

[図11]図11は、本発明の実施例5に係る双極型静電チャックXの分解斜視説明図である。

[図12]図12は、実施例5に係る双極型静電チャックXの第一電極と第二電極とを試料吸着面の法線方向にみた一部平面説明図である。

[図13]図13は、本発明の実施例6に係る双極型静電チャックXの第一電極と第二電極とを試料吸着面の法線方向にみた一部平面説明図である。

[図14]図14は、本発明の実施例7に係る双極型静電チャックXの分解斜視説明図である。

[図15]図15は、本発明の実施例8に係る双極型静電チャックの第一電極の一部平面説明図を示す。

[図16]図16は、本発明の実施例9に係る双極型静電チャックの第一電極の一部平面説明図を示す。

[図17]図17は、本発明の実施例10に係る双極型静電チャックXの一部断面説明図を示す。

[図18]図18は、本発明の実施例11に係る双極型静電チャックXの電極間絶縁層及び第一電極の一部断面説明図を示す。

[図19]図19は、参考例1の第一電極及び第二電極の平面説明図である。

[図20]図20は、参考例1に係る双極型静電チャックのグラディエント力の分布を2次元電界計算で求めた結果を示す。

[図21]図21は、参考例1に係る双極型静電チャックの電位等高線の分布図を2次元

電界計算で求めた結果を示す。

[図22]図22は、本発明の実施例1に係る双極型静電チャックのグラディエント力の分布を2次元電界計算で求めた結果を示す。

[図23]図23は、本発明の実施例1に係る双極型静電チャックの電位等高線の分布図を2次元電界計算で求めた結果を示す。

[図24]図24は、本発明の実施例3に係る双極型静電チャックのグラディエント力の分布を2次元電界計算で求めた結果を示す。

[図25]図25は、本発明の実施例3に係る双極型静電チャックの電位等高線の分布図を2次元電界計算で求めた結果を示す。

[図26]図26は、参考例1の双極型静電チャックをモデルとして、上部絶縁層の体積抵抗率を変化させた場合の時定数を示すグラフである。

[図27]図27は、吸着力の帯状電極幅(電極間隙間)に対する最適化を示すグラフである。

[図28]図28は、従来例を示す双極型静電チャックの断面説明図である。

符号の説明

- [0043] X:双極型静電チャック、1,11:上部絶縁層、2,12,22,32,42,52,62:第一電極、2a:帯状部分、2b:根元部分、12a:隙間部分、22a:円形部分、22b:環状部分、22c:接続部分、32a,42a:開口部、3,13,23:電極間絶縁層、4,14,24,34,44,54,64:第二電極、4a,14a:帯状部分、4b,14b:根元部分、34a,44a:中央リング、34b,44b:環状部分、34c,44c:接続部分、5,15:下部絶縁層、6:金属基盤、7:試料吸着面、8:ガラス基板、9:絶縁体、10:直流電源

発明を実施するための最良の形態

- [0044] 以下、添付図面に示す実施例に基づいて、本発明の好適な実施の形態を具体的に説明する。尚、本発明における双極型静電チャックは以下の実施例の場合に限定されない。

実施例 1

- [0045] 図1には、実施例1に係る双極型静電チャックXの分解斜視説明図が示されており、この双極型静電チャックXは、縦100mm×横100mm、膜厚50 μ m、及び比誘電

率 $\epsilon = 3.5$ であって下面に熱可塑性ポリイミドフィルムを有するポリイミドフィルムからなる上部絶縁層1と、膜厚 $3\mu\text{m}$ の銅からなる第一電極2と、縦 $100\text{mm} \times$ 横 100mm 、膜厚 $50\mu\text{m}$ 、及び比誘電率 $\epsilon = 3.5$ のポリイミドフィルムからなる電極間絶縁層3と、膜厚 $3\mu\text{m}$ の銅からなる第二電極4と、縦 $100\text{mm} \times$ 横 100mm 、膜厚 $50\mu\text{m}$ 、比誘電率 $\epsilon = 3.5$ であって上面に熱可塑性ポリイミドフィルムを有するポリイミドフィルムからなる下部絶縁層5と、縦 $100\text{mm} \times$ 横 $100\text{mm} \times$ 厚さ 10mm のアルミニウムからなる金属基盤6とから形成される。また、この双極型静電チャックXには、上部絶縁層1の上面からなる試料吸着面7に縦 $100\text{mm} \times$ 横 $100\text{mm} \times$ 厚さ 0.2mm であって比誘電率 $\epsilon = 5.5$ のガラス基板8が吸着・保持される。

[0046] この実施例1に係る双極型静電チャックXを次のようにして形成した。まず、上下両面(表裏両面)に銅表面層を有するポリイミド銅張積層シートのネオフレックス(三井化学株式会社製商品名)を用い、その上下両面にシルク印刷によって所定の電極のレジストパターンを形成し、次いで塩化第二鉄からなる腐食剤を用いてエッチングを行った。このようにして、縦 $80\text{mm} \times$ 横 80mm の領域を有する帯状くし歯の第一電極2、電極間絶縁層3(ポリイミドフィルム)、及び縦 $80\text{mm} \times$ 横 80mm の領域を有する帯状くし歯の第二電極4を形成した。

次に、上部絶縁層1を形成する下面に熱可塑性ポリイミドフィルムを有したポリイミドフィルム、第一電極2、ポリイミドフィルム(電極間絶縁層3)、第二電極4、及び下部絶縁層5を形成する上面に熱可塑性ポリイミドフィルムを有したポリイミドフィルムの順となるようにこれらを順次重ね、処理温度 150°C 、圧力 2MPa の条件で低温熱圧着成型を行って絶縁体9を形成した。そして、この絶縁体9を図示外の熱可塑性ポリイミドフィルムを介して上記と同じ条件の低温熱圧着処理を行って金属基盤6に固着し、双極型静電チャックXを完成させた。

この双極型静電チャックXについては、第一電極2側がマイナス極、及び第二電極4側がプラス極となるように直流電源10に接続され、また、金属基盤6はグランド電極とされる。電極に印加する電圧については、第一電極2側をプラス極、第二電極4側をマイナス電極としても上記と同様の吸着効果を発揮する。なお、第一電極2又は第二電極4のいずれかを 0V (GND) として残りの電極をプラス極又はマイナス極として、

互いの電極に電位差を生じさせるようにしてもよい。

[0047] 図2は、この実施例1に係る双極型静電チャックXの断面説明図(図1のA-A断面の一部)を示し、また、図3は、この実施例1に係る双極型静電チャックXの第一電極2と第二電極4とを試料吸着面7の法線方向にみた一部平面説明図を示す。尚、図2中に記した「z」は、下記の試験例5で説明する帯状電極幅と電極間隙間とを表す。

上述したように第一電極2が帯状くし歯に形成されると共に第二電極4が帯状くし歯に形成され、この第一電極2の帯状くし歯と第二電極4の帯状くし歯とが互い違いに入り組まれて試料吸着面7の法線方向に第一電極2と第二電極4とが互いに線で接して重なるように配置されている。帯状くし歯に形成された第一電極2の帯状部分2aは電極幅1mm及び厚さ3 μ mであり、この帯状部分2aは間隔1mmピッチで配列されて、電極幅3mm及び厚さ3 μ mの根元部分2bと一体になって帯状くし歯を形成している。同じく第二電極4の帯状部分4aは電極幅1mm、厚さ3 μ mであり、この帯状部分4aは間隔1mmピッチで配列され、電極幅3mm、厚さ3 μ mの根元部分4bと一体になって帯状くし歯を形成している。また、第一電極2と第二電極4との間の電極間距離Yは上記電極間絶縁層3の膜厚の値に相当する50 μ mである。

ところで、電極間絶縁層3を形成する上記ポリイミドフィルムは、絶縁耐圧160MV/mであるため、この実施例1に係る双極型静電チャックXでは8kVの絶縁耐性を備えることになる。

実施例 2

[0048] 図4は、実施例2に係る双極型静電チャックXの断面説明図を示し、また、図5は、この実施例2に係る双極型静電チャックXの第一電極2と第二電極14とを試料吸着面7の法線方向にみた一部平面説明図を示す。

この実施例2の双極型静電チャックXは、第二電極14の帯状部分14aの電極幅を0.6mmに形成し、この第二電極14の帯状部分14aが、第一電極2の帯状部分2aによって形成される隙間(1mm)の中央に位置するように配置され、第一電極2の帯状くし歯と第二電極14の帯状くし歯とが互い違いに入り組まれ、試料吸着面7の法線方向に第一電極2と第二電極14とがそれぞれの帯状部分2a、14aの先端とそれぞれの根元部分2b、14bとが線で接して重なるように配置されている(試料吸着面7の法線方

向に第一電極2の帯状部分2aと第二電極14の帯状部分14aとの距離は0.2mmである)。上記以外の条件は実施例1と同様にして、この実施例2に係る双極型静電チャックXを完成させた。

実施例 3

[0049] 図6には実施例3に係る双極型静電チャックXの分解斜視説明図が示されている。また、図7は、この実施例3に係る双極型静電チャックXの断面説明図(図6のA-A断面の一部)を示し、図8は、この実施例3に係る双極型静電チャックXの第一電極2と第二電極24とを試料吸着面7の法線方向にみた一部平面説明図を示す。尚、この図8中で点を付した領域部分は第二電極24が試料吸着面7の法線方向に第一電極2と重なる部分を表す。

この実施例3の双極型静電チャックXは、第二電極24が縦80mm×横80mmの平面領域を有する平板状に形成した以外の条件は上記実施例1と同様にして、双極型静電チャックXを完成させた。

実施例 4

[0050] 図9には、実施例4に係る双極型静電チャックXの分解斜視説明図が示されている。また、図10は、この実施例4に係る双極型静電チャックXの第一電極12と第二電極24とを試料吸着面7の法線方向にみた一部平面説明図を示す。尚、この図10中で点を付した領域部分は第二電極24が試料吸着面7の法線方向に第一電極12と重なる部分を表す。

この実施例4の双極型静電チャックXでは、第一電極12は井桁状に形成されており、縦100mm×横100mmの領域を縦3mm×横3mmの隙間部分12aが縦横3mmピッチ(井桁を形成する電極幅3mm)で配列された形状を有している。上記以外の条件は実施例3と同様にして、この実施例4に係る双極型静電チャックXを完成させた。尚、上記のように井桁状に第一電極12を形成した場合は、外からの衝撃等で電極の一部が切断されても電位供給が可能となる。

実施例 5

[0051] 図11には実施例5に係る双極型静電チャックXの分解斜視説明図が示されており、また、図12は、この実施例5に係る双極型静電チャックXの試料吸着面7から法線

方向に第一電極22及び第二電極34をみた中心付近の一部平面説明図を示す。尚、この図12中で濃く表示した(塗りつぶした)部分は第二電極34が試料吸着面7の法線方向に第一電極22と重なる部分を表す。

この実施例5に係る第一電極22は、半径2mmの円形部分22aを中心として、電極幅3mmであって互いの電極間の間隔が5mmとなるように同心円状に形成された環状部分22bを有すると共に、これら円形部分22aと環状部分22bとを結ぶ電極幅1mmの接続部分22cとを有し、全体で半径100mmの同心円電極を形成している。一方、第二電極34は、内径3mm及び外径6mmの中央リング34aを中心に、電極幅3mmであって互いの電極間の間隔が5mmとなるように同心円状に形成された環状部分34bを有すると共に、これら中央リング34aと環状部分34bとを結ぶ電極幅1mmの接続部分34cとを有し、全体で半径100mmの同心円電極を形成している。上記以外の条件は実施例1と同様にして、この実施例5に係る双極型静電チャックXを完成させた。

この実施例5に係る第一電極22と第二電極34とを試料吸着面7の法線方向にみると、環状部分22b、34bが互いに距離 $d=1\text{mm}$ を有すると共に、この第二電極34の接続部分34cは試料吸着面7の法線方向に上記第一電極22の接続部分22cと重なるように配置されている。

実施例 6

[0052] 図13は、実施例6に係る双極型静電チャックXの試料吸着面7から法線方向に第一電極22及び第二電極44をみた一部平面説明図を示す。尚、この図13中で濃く表示した(塗りつぶした)部分は第二電極44が試料吸着面7の法線方向に第一電極22と重なる部分を表す。

この実施例6に係る第二電極44は、内径2mm及び外径7mmの中央リング44aを中心に、電極幅5mmであって互いの電極間の間隔が3mmとなるように同心円状に形成された環状部分44bを有すると共に、これら中央リング44aと環状部分44bとを結ぶ接続部分44cとを有し、全体で半径100mmの同心円電極を形成している。上記以外の条件は実施例5と同様にして、この実施例6に係る双極型静電チャックXを完成させた。

この実施例6に係る第一電極22と第二電極44とを試料吸着面7の法線方向にみる

と、環状部分22b、44bが互いに線で接するように重なると共に、この第二電極44の接続部分44cは試料吸着面7の法線方向に上記第一電極22の接続部分22cと重なるように配置されている。

実施例 7

- [0053] 図14には、実施例7に係る双極型静電チャックXの分解斜視説明図が示されており、この実施例7に係る第二電極54は半径100mmの円形領域を有するように形成されている。上記以外の条件は実施例5と同様にして、この実施例7に係る双極型静電チャックXを完成させた。

実施例 8

- [0054] 図15には、実施例8に係る双極型静電チャックXの第一電極32の一部平面説明図を示す。第一電極32は、厚さ $3\mu\text{m}$ で直径300mmの円形領域を有し、この円形領域の中には半径0.6mmの円形の開口部32aが均一に存在している。図15はこの円形領域の中心部付近の様子を示す一部平面説明図である。この第一電極32において一つの開口部32aに着目すると、その周りに開口部32aが6つ存在し、これらの6つの開口部32aは正六角形の頂点にそれぞれの中心が位置するように配置されている。中央の開口部32aの中心と正六角形の頂点部分に位置する開口部32aの中心との距離Rは1.5mmであり、中央の開口部32aと隣り合う開口部32aとの間隔rは0.3mmである。

上記以外の条件は、実施例3と同様にして、この実施例8に係る双極型静電チャックXを完成させた。このように円の形状をした開口部32aであれば、開口部の角の処理が比較的容易であり、均一なグラディエント力を形成できる。

実施例 9

- [0055] 図16には、実施例9に係る双極型静電チャックXの第一電極42の一部平面説明図を示す。第一電極42は、厚さ $3\mu\text{m}$ で直径300mmの円形領域を有し、この円形領域の中には一辺が0.6mmの正六角形をした開口部42aが均一に存在している。図16はこの円形領域の中心付近の様子を示す平面説明図である。この第一電極42において一つの開口部42aに着目すると、その周りに6つの開口部42aが互いに各辺が平行となるように配置されている。中央の開口部42aの中心と隣接する開口部42aの

中心との距離Rは1.5mmであり、隣接する開口部42a同士の間隔rは0.3mmである。

上記以外の条件は、実施例3と同様にして、この実施例9に係る双極型静電チャックXを完成させた。このように正六角形の開口部42aを有した第一電極42では、電極の線幅が均一に形成できるため、より均一な吸着力を実現できる。

実施例 10

[0056] 図17は、実施例10に係る双極型静電チャックXの一部断面説明図を示しており、この双極型静電チャックXは、縦100mm×横100mm×厚さ10mmのアルミニウムからなる金属基盤6の表面に、アルミナを用いてプラズマによる溶射によって縦100mm×横100mm×膜厚0.2mmのセラミックス層からなる下部絶縁層15を形成した。次いで、溶射によって形成したこのセラミックス層の上面を機械加工により表面粗さRaが10 μ mとなるように平坦化した。

次に、上記で形成した下部絶縁層15の表面にモリブデンを溶射し、縦100mm×横100mm×膜厚50 μ mの第二電極64を形成した。この際用いる金属は、熱歪を抑えるため熱膨張係数が上記で溶射して形成した下部絶縁層15のセラミック材と同程度とする必要があることから上記のようにモリブデンを用いた。

[0057] 更に、上記で形成した第二電極64の表面に、下部絶縁層15と同様の手段によって縦100mm×横100mm×膜厚0.1mmの電極間絶縁層13を形成した。この電極間絶縁層13の表面を下部絶縁層15の場合と同様に平坦化した後、実施例1における第一電極2と同じ形状の帯状くし歯となるように上記電極間絶縁層13の表面に所定のマスキングを行い、膜厚50 μ mとなるようにモリブデンを溶射して第一電極52を形成した。この第一電極52を形成する際には、第二電極64の場合と同様に電極間絶縁層13との熱膨張係数が同程度となるようにモリブデンを用いた。次いで、下部絶縁層15及び電極間絶縁層13を形成した手段と同様にして、上記第一電極52の表面にアルミナを溶射して、縦100mm×横100mm×膜厚0.1mmの上部絶縁層11を形成した。この上部絶縁層11については、その表面を研磨した後、溶射層の表面全面を封孔するための真空含浸をエポキシあるいはシリコンで行い、全表面、特に試料吸着面7となる部分の平坦度を表面粗さRaが5～20 μ mの範囲で製造プロセス要求される基準値、偏差内となるように機械加工を行った。その後、有機溶剤の中で超

音波洗浄処理を行い、静電チャックXを完成させた。尚、この実施例10に係る第一電極52と第二電極54との電極間距離Yは0.1mmである。

- [0058] 上記のように、第一電極、第二電極、電極間絶縁層、上部絶縁層及び下部絶縁層を溶射によるセラミックスから形成した絶縁体を含む静電チャックによれば、これらのセラミックスは摩耗に強いことから、パーティクル発生が多い等の使用する環境が厳しい場合でも、その耐性において優れた性能を発揮する。また、比較的安価に作製することができることから量産に適している。

実施例 11

- [0059] 図18は、実施例11に係る双極型静電チャックXにおける電極間絶縁層23及び第一電極62の一部断面説明図を示す。実施例10と同様にして、金属基盤6に下部絶縁層15及び第二電極64を形成したものを用意した。次に、縦100mm×横100mm×厚さ0.1mmのアルミナからなるセラミックス薄板を電極間絶縁層23として、この上面(試料吸着面7側)に実施例10と同様にして第一電極62を形成した。

次いで、一体に形成しておいた金属基盤6、下部絶縁層15及び第二電極64の上面(第二電極64の上面)に上記電極間絶縁層23を積層させ、エポキシ接着剤を介して固着させた。次に、実施例10と同様にして、第一電極62の表面に上部絶縁層11を形成した。上部絶縁層11の表面研磨、封孔処理、平坦化のための機械加工、及び超音波洗浄処理を実施例10と同様に行い、静電チャックXを完成させた。

この実施例の静電チャックXのように、絶縁耐性が最も要求される電極間絶縁層をセラミックス薄板から形成することで、電極間の絶縁の信頼性が向上し、本発明において電極間にポリイミドシートを介在させた場合と同等の絶縁耐性を発揮する。

- [0060] [試験例1]

上記実施例1及び実施例3の双極型静電チャックXについて、2次元電界計算により計算モデルを作成し、単位面積あたりの吸着力(グラディエント力)をエネルギー変化方法によって算出した。算出条件として、印加電圧をいずれも±1500Vとした。結果を表1に示す。

また、参考例1として、図19に示したように帯状くし歯に形成した第一電極2と第二電極4とを互い違いに入り組むようにして同一平面に配置した双極型静電チャックの

計算モデルを作成した。この参考例1では、第一電極2と第二電極4とが電極間ピッチ1mm(両電極の帯状部分の電極幅1mm)となるように同一平面内に配列される。また、これら第一電極2と第二電極4とを、ポリイミドからなる上部絶縁層とポリイミドからなる下部絶縁層とで挟み、隣り合う電極に異なる極性の電位を与えるようにして双極型静電チャックとする。結果を表1に示す。

[0061] [表1]

	吸着力 (gf/cm ²)	静電容量 (pF/cm ²)
実施例 1	1 1 . 0	1 0 0
実施例 3	1 1 . 0	6 5 0
参考例 1	2 . 8	1 7 0

[0062] 実施例1及び実施例3の結果は、いずれも参考例1と比較して約4倍であることが分かる。尚、参考例1の結果は、上記で説明した非特許文献1に開示された結果に近い値が算出されていることから、試料の違いがあるものの(本発明の参考例1ではガラス基板であるのに対し、非特許文献1ではシリコンウエハ)、この試験例1の計算結果は他の事例においても信頼できると考えられる。

[0063] [試験例2]

上記実施例1、実施例3及び参考例1の双極型静電チャックXの静電容量を上記試験例1と同じ計算により算出した。この静電容量は残留吸着力(電圧印加をやめて、ガラス基板8を試料吸着面7から取り外す際の残留電荷によるはがれにくさ)に比例すると考えられる。結果を表1に示す。この結果より、静電容量に関しては第一電極と第二電極とが試料吸着面の法線方向に重ならない方が有利であることが分かる。

[0064] [試験例3]

上記実施例1、実施例3及び参考例1におけるグラディエント力と電位等高線の分布図を2次元電界計算により計算モデルを作成して算出した。結果を図20～図25に示す(図20及び図21が参考例1、図22及び図23が実施例1、図24及び図25が実施例3を示す)。尚、各図においては各モデルの電極部分を拡大して表示している。

ここでグラディエント力 F_y は試料吸着面7の法線方向 y について以下の式(2)で表すものである。

$$F_y = \partial (Ey^2) / \partial y \cdots \cdots (2)$$

[0065] 図22及び図24は、図20と比較して、図中点線で囲む範囲で色の濃い部分(グラディエント力の強い部分)が広く存在していることが読み取れることから、実施例1及び実施例3の静電チャックは参考例1の場合と比べていずれも優れたグラディエント力を有することが分かる。尚、図23及び図25から、このグラディエント力は等電位等高線が狭いところから広がる部分において存在することが分かる。

[0066] [試験例4]

参考例1の双極型静電チャックをモデルとして、上部絶縁層の体積抵抗率を変化させて導電性層を想定した場合の時定数の変化をグラフにした。結果を図26に示す。体積低効率をポリイミドの持つ $1E14 \Omega \cdot m$ からさらに減らしていくと、時定数が小さくなる。およそ $1E10 \Omega \cdot m$ 位のところで、時定数は3桁落ちとなって、はがれやすさに貢献すると考えられる。これは、ガラス基板に蓄積された電荷が導電性層を通して電極へ流れ込み、これが最終的には電源内部で自然に或は外部に取り付ける放電部等によって取り除かれるためである。

[0067] [試験例5]

上記実施例1のような帯状くし歯の第一電極2と帯状くし歯の第二電極4とを有し、上部絶縁層1、電極間絶縁層3及び下部絶縁層5をそれぞれ実施例1と同じように膜厚 $50 \mu m$ のポリイミドフィルムから形成した双極型静電チャックをモデルにした場合、第一電極2における帯状部分2aの幅 z (帯状電極幅 z)と隣接する帯状部分2aの間隔 z (電極間隙間 z)とを等しくすると共に、第二電極4における帯状部分4aの幅 z (帯状電極幅 z)と隣接する帯状部分4aの間隔 z (電極間隙間 z)とを等しくするようにして、この z (=帯状電極幅=電極間隙間)を変化させて試料吸着面における単位面積あたりの吸着力(gf/cm^2)を計算により求めた。結果を図27に示す。図27においては、 $z=1mm$ を1とした場合の吸着力の比を示す吸着力の相対比[グラフ向かって左側の軸]、 $\pm 1.5kV$ の電位を供給した場合の吸着力(gf/cm^2) [グラフ向かって左側の軸]、及び $\pm 1.5kV$ の電位を供給した場合に第一電極2を形成する帯状くし歯のくし歯一

本(帯状部分2a)に働く単位長さあたりの吸着力(N/m) [グラフ向かって右側の軸]の各値の変化をグラフにして表している。このグラフより、 z が0.15〜0.5mmの間に相対比及び $\pm 1.5\text{kV}$ の電位を供給した場合の吸着力(gf/cm^2)の最大点があり、およそ0.3mmのところがその最大点に相当する。この結果より明らかなように、 $\pm 1.5\text{kV}$ の電位を供給した場合に、最大 $30\text{gf}/\text{cm}^2$ の吸着力が得られることが分かった。この値は上記試験例1における参考例1の吸着力の10倍を超える。

[0068] また、電極間絶縁層3を形成するポリイミドフィルムの膜厚を $25\mu\text{m}$ とした場合と $75\mu\text{m}$ とした場合とについて、その他の条件は上記と同様にして、 z (=帯状電極幅=電極間隙間)を変化させて試料吸着面における単位面積あたりの吸着力(gf/cm^2)を計算により求めた。その結果、先の結果と同様に、いずれの膜厚の場合も z が0.15〜0.5mmの間で吸着力が最大となり、およそ0.3mmのところがその最大点となった。電極間絶縁層の膜厚が $25\mu\text{m}$ の場合では、 $\pm 1.5\text{kV}$ の電位を供給したときに最大吸着力が $46\text{gf}/\text{cm}^2$ の値を示し、電極間絶縁層の膜厚が薄くなるほど吸着力が増大することが分かった。

尚、試験例5の内容については、第二電極が所定の平面領域を有する平板状に形成した場合でも同様の結果を示した。すなわち、実施例3のように帯状くし歯の第一電極2と所定の平面領域を有する平板状の第二電極24とを有する双極型静電チャックのモデルにおいて、上記試験例5に係る条件で計算を行った場合でも、図27のグラフに示した結果と同様の結果が得られることが分かった。

産業上の利用可能性

[0069] 本発明における双極型静電チャックは、電界強度に優れて強いグラディエント力を発揮するため、吸着・保持する試料の平坦性を優れたものとすることができると共に、大型の試料であっても十分な吸着力を発揮する。特に、近時の第四世代と言われる液晶ディスプレイ用のガラス基板は $900\text{mm} \times 1100\text{mm}$ であり、このガラス基板を吸着させる静電チャックを実現するには、例えば $300\text{mm} \times 400\text{mm}$ の本発明の静電チャックを作製し、これらを9枚均一に取り付けることのできる装置台に配置させることで可能となる。

また、本発明における双極型静電チャックは、グラディエント力からなる吸着力のみ

ならず、例えば $100\text{gf}/\text{cm}^2$ 程度の吸着力を有するクーロン力もグラディエント力に加えて発揮するため、シリコンウエハ等の半導体基板の吸着保持にも使用することができる。すなわち、この双極型静電チャックを用いれば、上記ガラス基板等の絶縁性基板とシリコンウエハ等の半導体基板とを同じ装置で処理することができ、いずれの場合においても電極に印加する電圧をできるだけ低くした最適化された条件で信頼性よくこれらの基板を吸着保持することができる。

また、電極への電圧の印加を終えた後に試料吸着面からの試料のはがし取りにくさを可及的に解消できる。そのため、近時大型化が進む液晶パネル分野や半導体製造分野をはじめとして、各種フラットパネルディスプレイの製造分野や、シリコン、アモルファスシリコン、ガリウムリン、ガリウム砒素、シリコンオンインシュレータ等の半導体基板、あるいはソーダライムガラス、低アルカリガラス、無アルカリガラス等のガラス基板、更に近未来に実現可能とされているフレキシブルディスプレイ用の樹脂性フィルム基板等の製造工程に関わる分野等において特に有益である。

請求の範囲

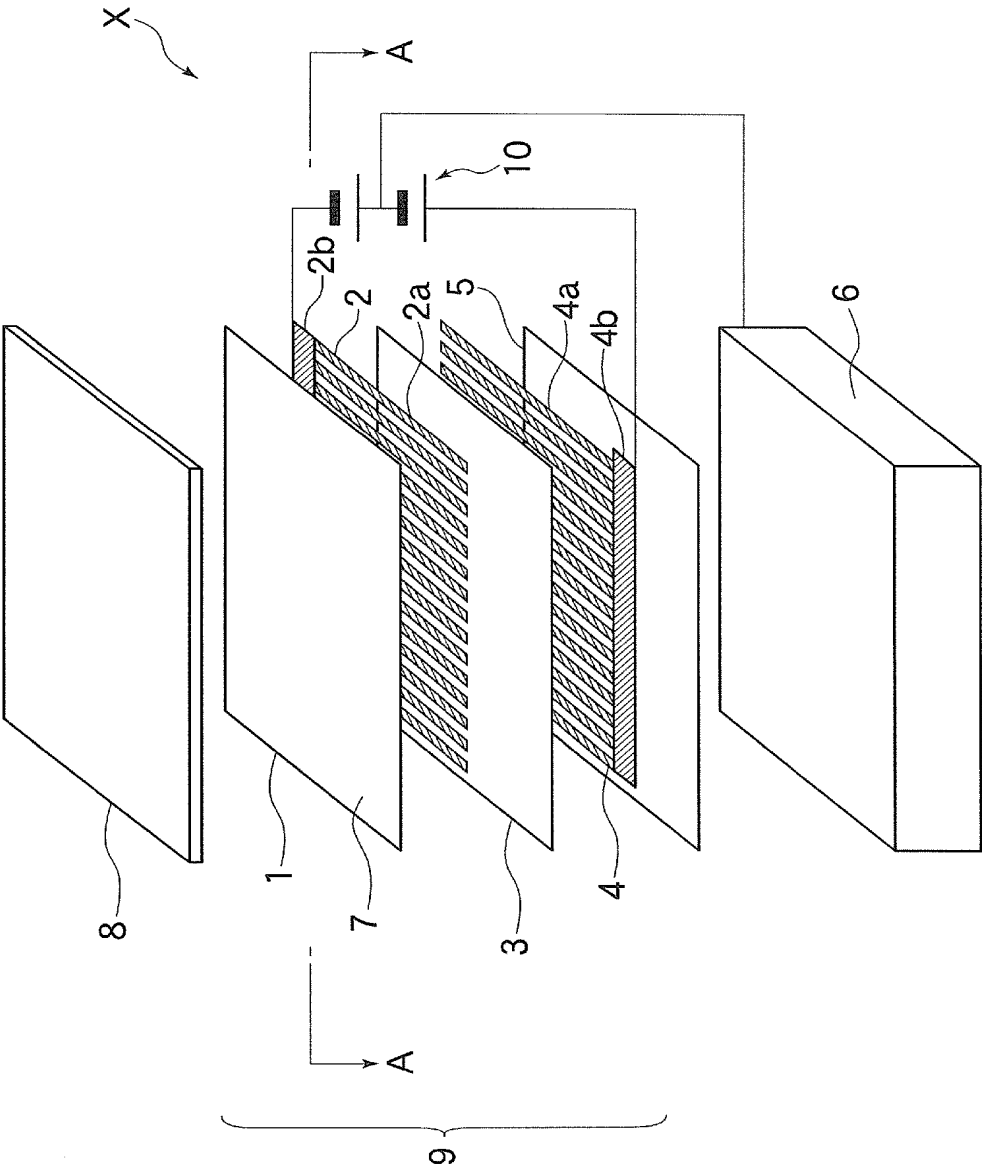
- [1] 絶縁体の内部に第一電極と第二電極とを備えてこの絶縁体の表面を試料吸着面とする双極型の静電チャックであり、上記絶縁体はその深さ方向に試料吸着面から近い順に第一電極、電極間絶縁層、及び第二電極を有し、この第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極に対して非重畳領域を有することを特徴とする双極型静電チャック。
- [2] 絶縁体はその深さ方向に試料吸着面から近い順に上部絶縁層、第一電極、電極間絶縁層、第二電極、及び下部絶縁層を有する請求項1に記載の双極型静電チャック。
- [3] 第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極と重ならない請求項1又は2に記載の双極型静電チャック。
- [4] 第一電極が帯状くし歯に形成されると共に第二電極が帯状くし歯に形成され、これら2つの帯状くし歯が互い違いに入り組まれて第二電極が試料吸着面の法線方向に第一電極と重ならない請求項3に記載の双極型静電チャック。
- [5] 第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に第一電極と重なる請求項1又は2に記載の双極型静電チャック。
- [6] 第一電極が帯状くし歯に形成されると共に第二電極が所定の領域を有する平板状に形成され、この第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に上記第一電極と重なる請求項5に記載の双極型静電チャック。
- [7] 第一電極が井桁状に形成されると共に第二電極が所定の領域を有する平板状に形成され、この第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に上記第一電極と重なる請求項5に記載の双極型静電チャック。
- [8] 第一電極が所定の領域内に円形、三角形、正方形、長方形、及び四角形以上の多角形から選ばれた1以上の形状をした開口部を複数有したメッシュ状に形成されると共に第二電極が所定の領域を有する平板状に形成され、この第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に上記第一電極と重なる請求項5に記載の双極型静電チャック。
- [9] 第一電極が所定の幅を有するリング状に形成されると共に第二電極が所定の円形

領域を有する平板状に形成され、この第二電極の一部が試料吸着面の法線方向に上記第一電極と重なる請求項5に記載の双極型静電チャック。

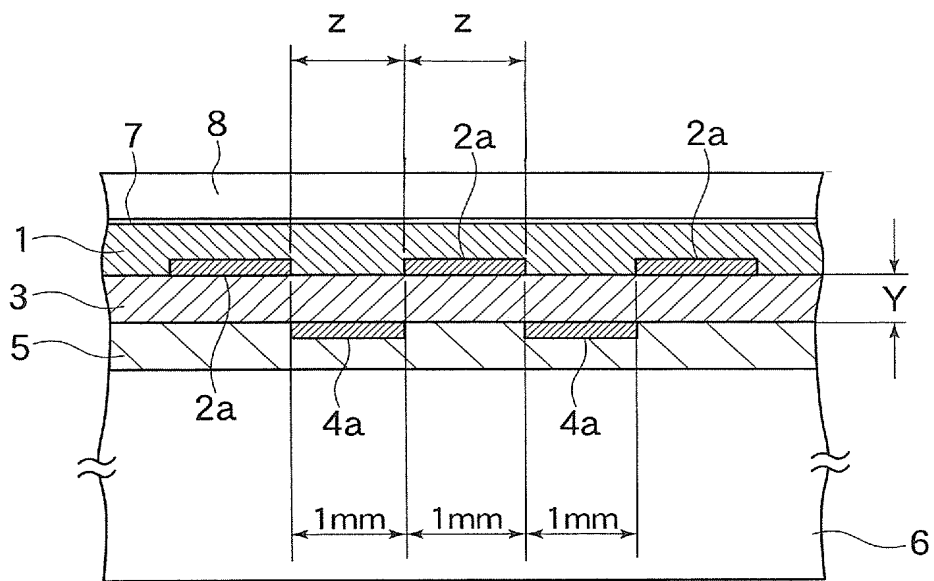
- [10] 第一電極が、所定の円形領域を有する円形部を中心にしてこの円形部から所定の間隔をおいて同心円状に並ぶ第一環状部を有し、かつ、上記円形部と第一環状部とを結ぶ第一接続部を有するように形成され、また、第二電極が、上記第一電極の円形部と第一環状部との間隔より小さい幅を有する環状に形成され、この第二電極が試料吸着面の法線方向にみて上記第一電極の円形部と第一環状部との間に配置される請求項5に記載の双極型静電チャック。
- [11] 第一電極が、所定の円形領域を有する円形部を中心にしてこの円形部から所定の間隔をおいて同心円状に並ぶ第一環状部を有し、かつ、上記円形部と第一環状部とを結ぶ第一接続部を有するように形成され、また、第二電極が、上記第一電極の円形部と第一環状部との間隔と同じ幅を有する環状に形成され、この第二電極が試料吸着面の法線方向にみて上記第一電極の円形部と第一環状部との間に配置される請求項5に記載の双極型静電チャック。
- [12] 第一電極が、互いに所定の間隔をおいて同心円状に並ぶ2つ以上の第一環状部を有し、第二電極が、互いに所定の間隔をおいて同心円状に並ぶ2つ以上の第二環状部を有し、かつ、各第二環状部の間を結ぶ第二接続部とを有する請求項10又は11に記載の双極型静電チャック。
- [13] 第一電極と第二電極との間の電極間距離が $1\ \mu\text{m}$ 以上 $1000\ \mu\text{m}$ 以下である請求項1又は2に記載の双極型静電チャック。
- [14] 第一電極を帯状くし歯に形成し、この第一電極の帯状電極幅 z と電極間隙間 z とを等しくした場合、この z が $0.15\text{--}0.5\text{mm}$ の範囲内である請求項1又は2に記載の双極型静電チャック。
- [15] 電極間絶縁層が、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、エポキシ、及びアクリルから選ばれた1種又は2種以上の樹脂からなる樹脂層である請求項1又は2に記載の双極型静電チャック。
- [16] 樹脂層が1又は2以上の樹脂フィルムからなる請求項15に記載の双極型静電チャック。

- [17] 電極間絶縁層が、酸化アルミ、窒化アルミ、炭化珪素、窒化珪素、ジルコニア及びチタニアから選ばれた1種又は2種以上からなるセラミックス層である請求項1又は2に記載の双極型静電チャック。
- [18] 電極間絶縁層が、珪素及び二酸化珪素から選ばれた1種又は2種からなる請求項1又は2に記載の双極型静電チャック。
- [19] 絶縁体の表面に更に導電性層を形成し、この導電性層の表面を試料吸着面とする請求項1又は2に記載の双極型静電チャック。
- [20] 第一電極の一部又は全部を試料吸着面の法線方向に切った断面形状が、長方形、正方形、円形、及び三角形から選ばれた形状である請求項1又は2に記載の双極型静電チャック。
- [21] 第二電極の一部又は全部を試料吸着面の法線方向に切った断面形状が、長方形、正方形、円形、及び三角形から選ばれた形状である請求項1又は2に記載の双極型静電チャック。

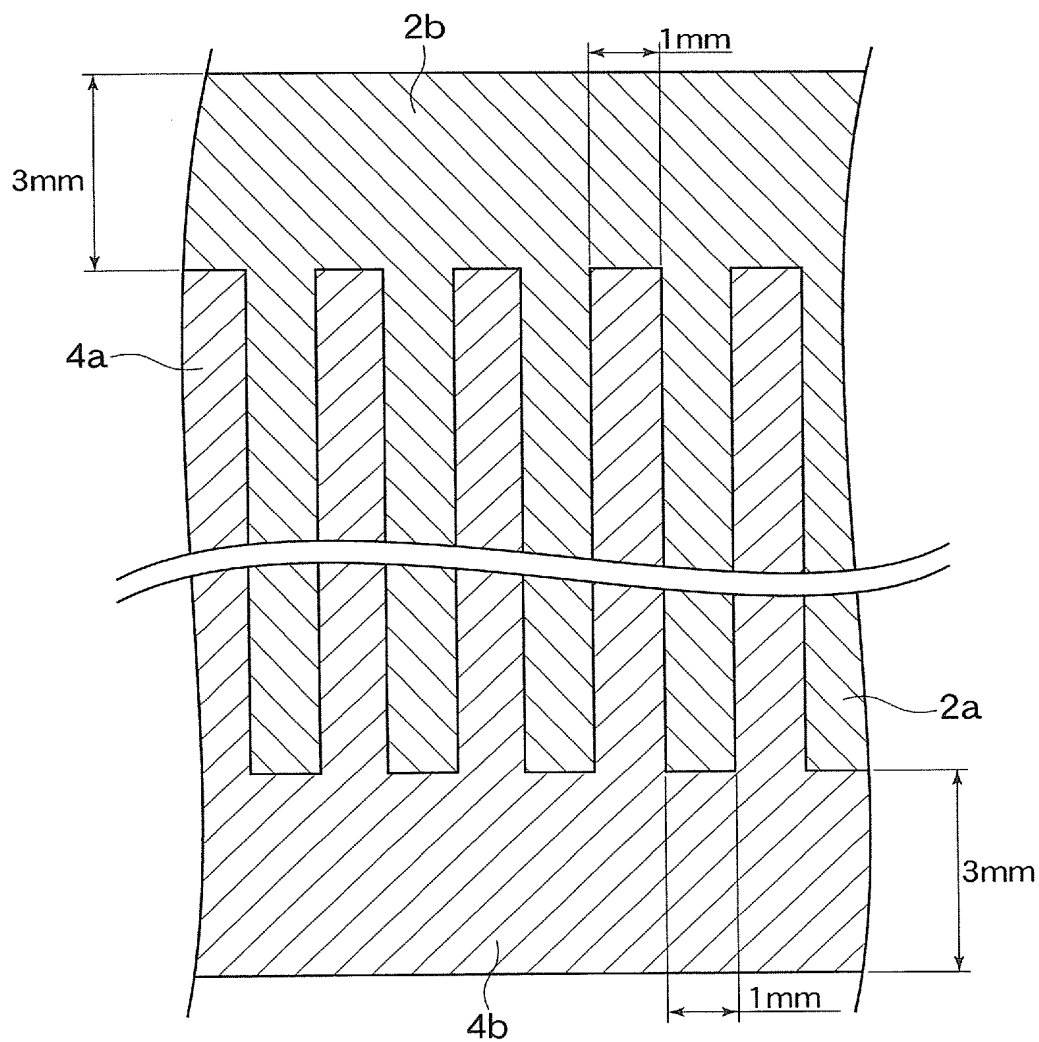
[図1]



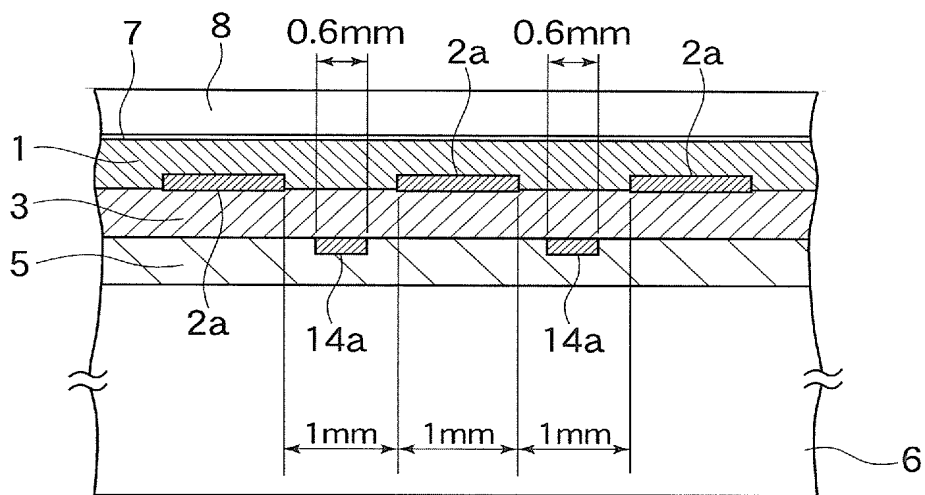
[[図2]]



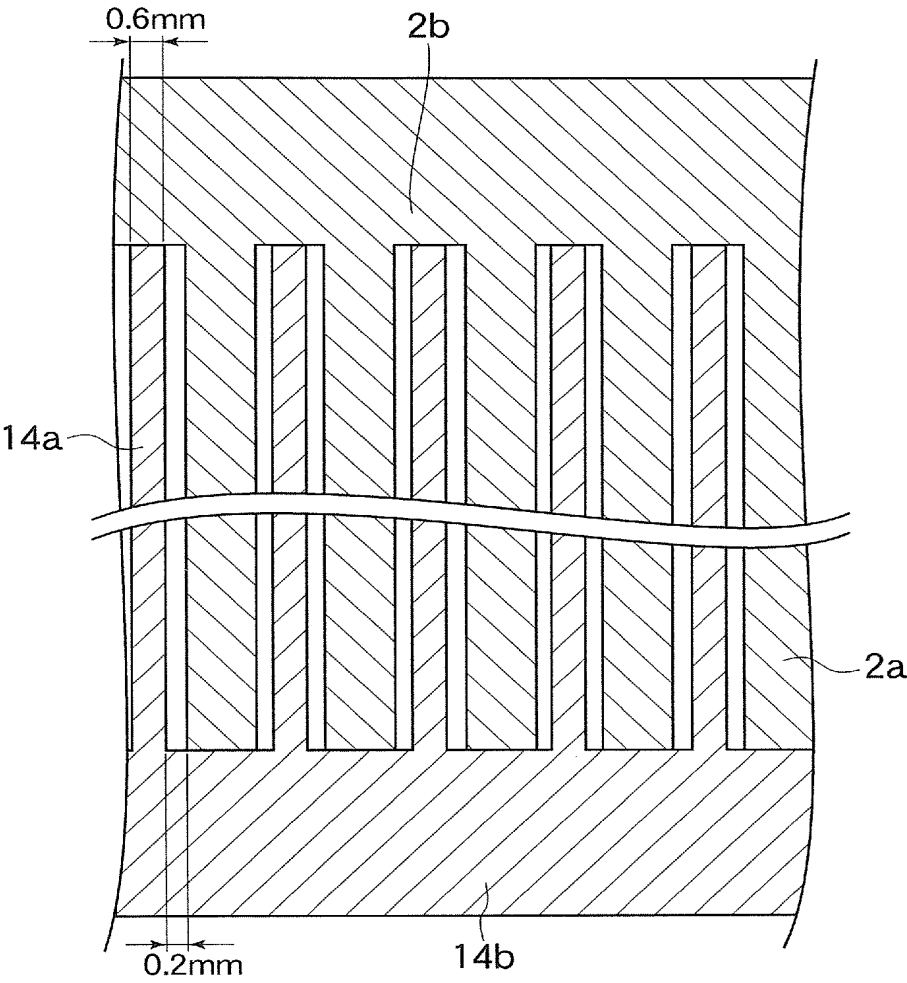
[[図3]]



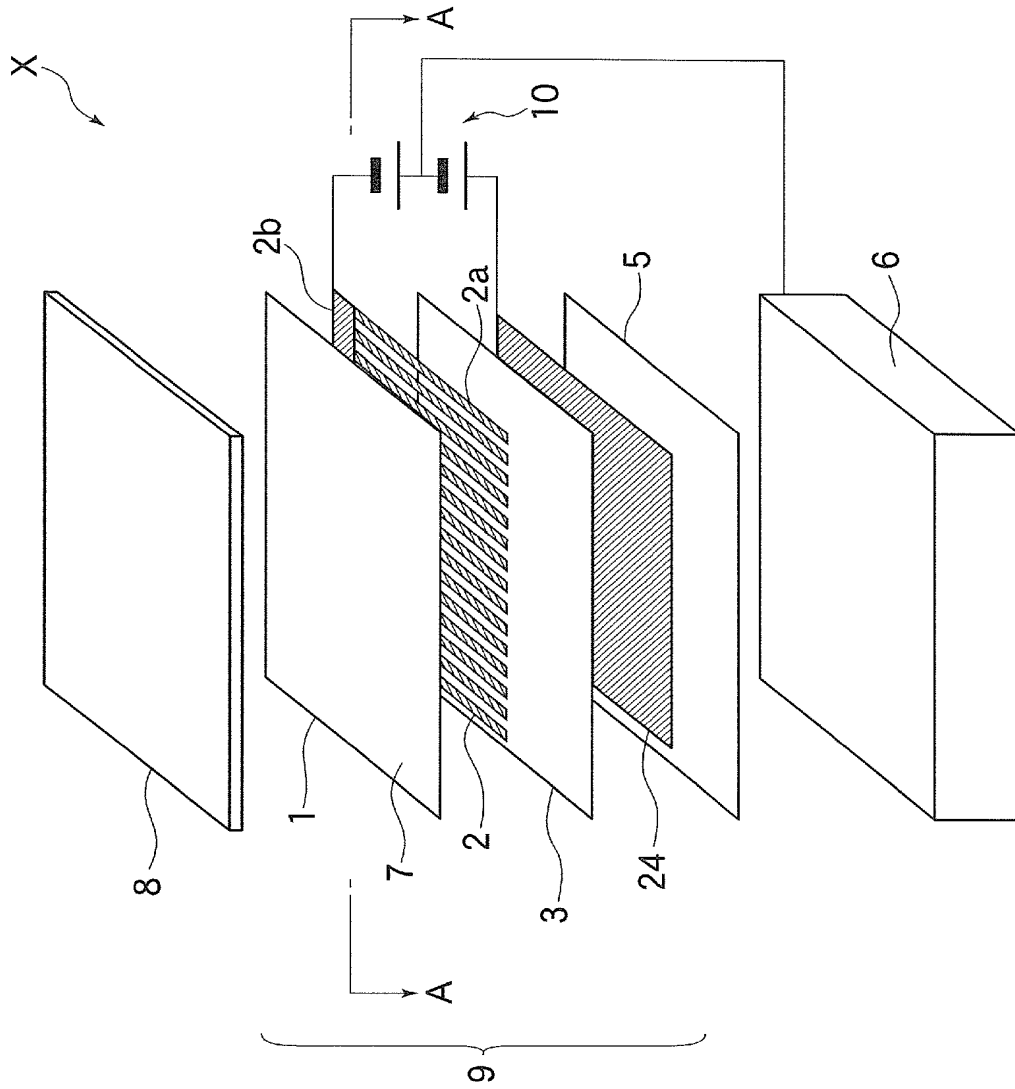
[[図4]]



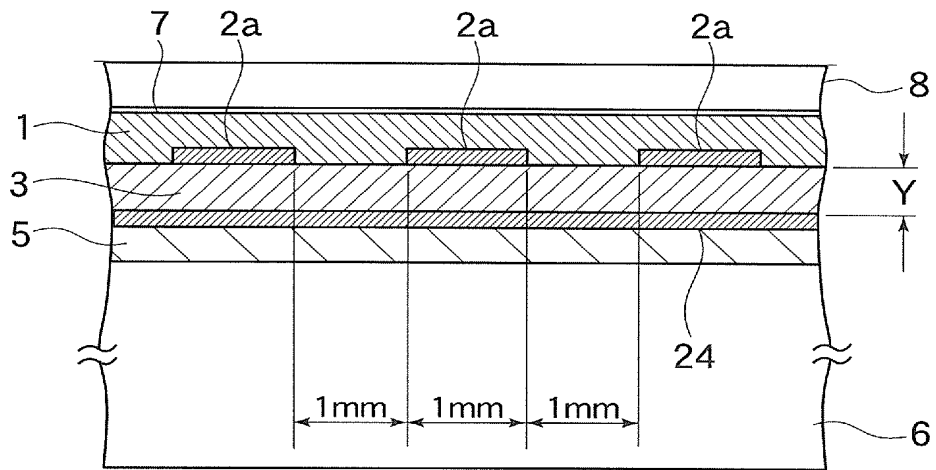
[図5]



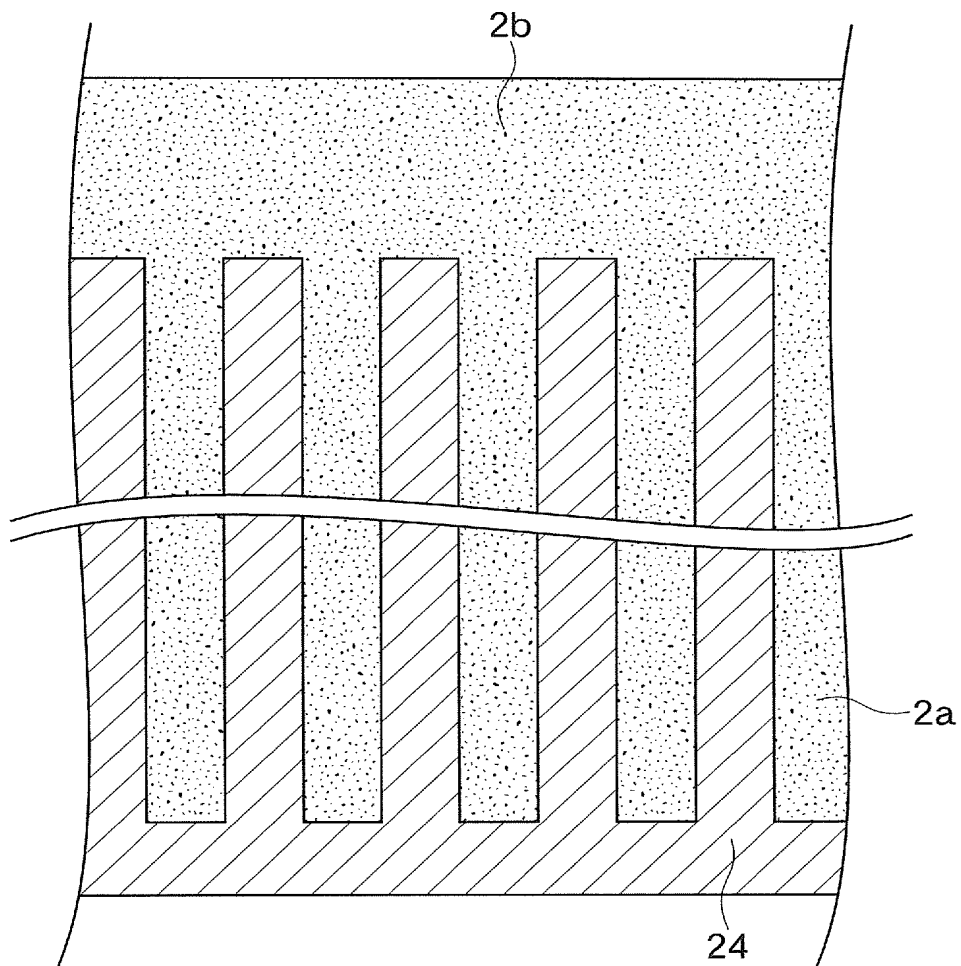
[図6]



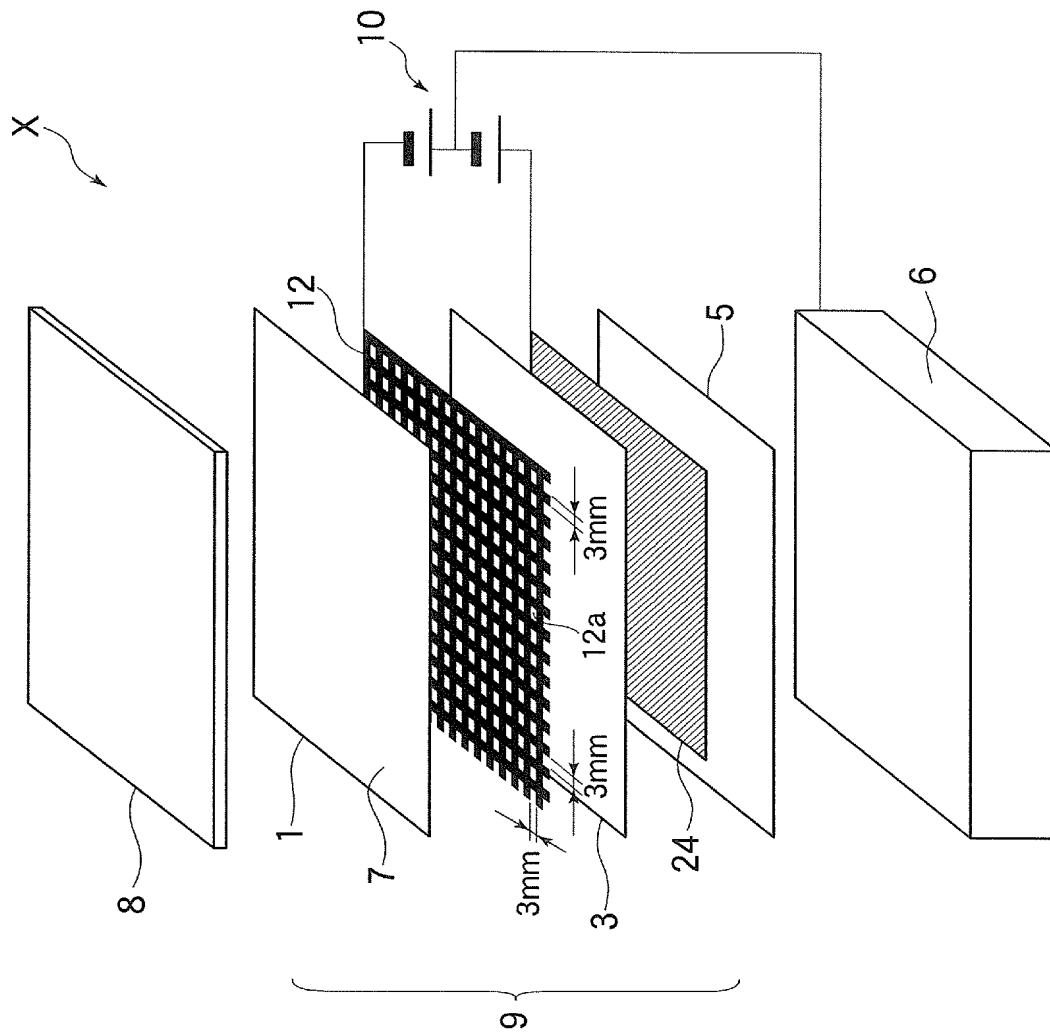
[図7]



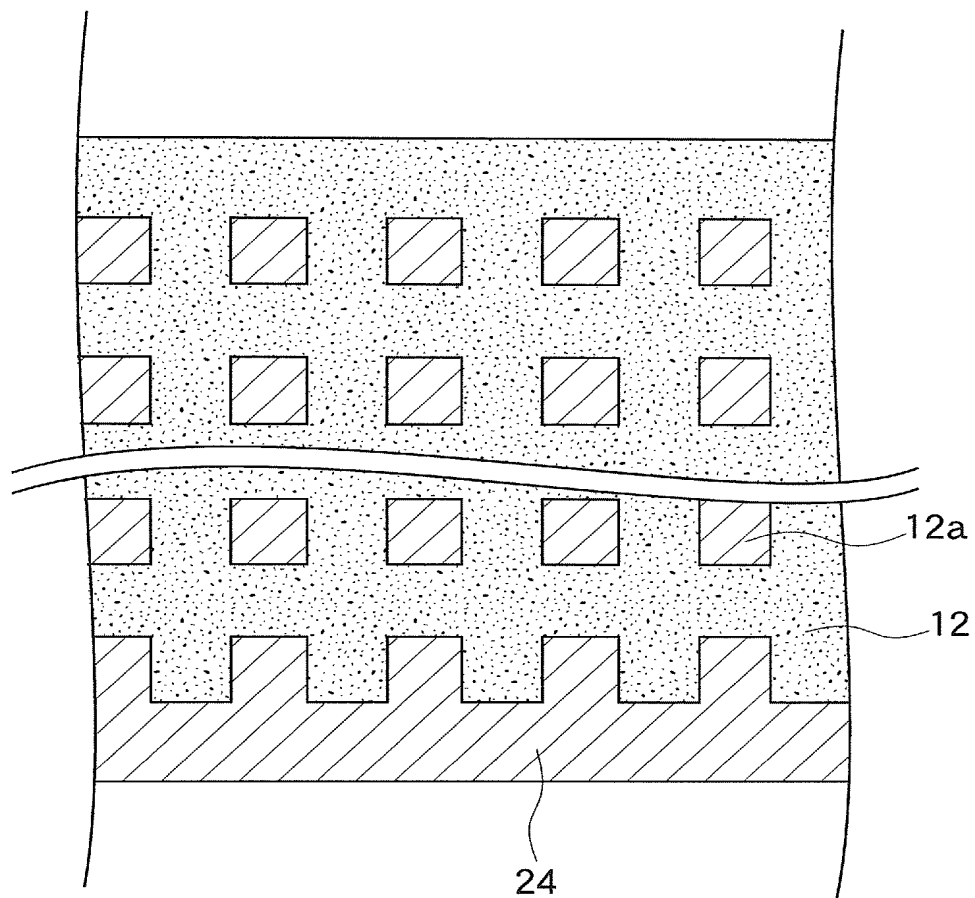
[図8]



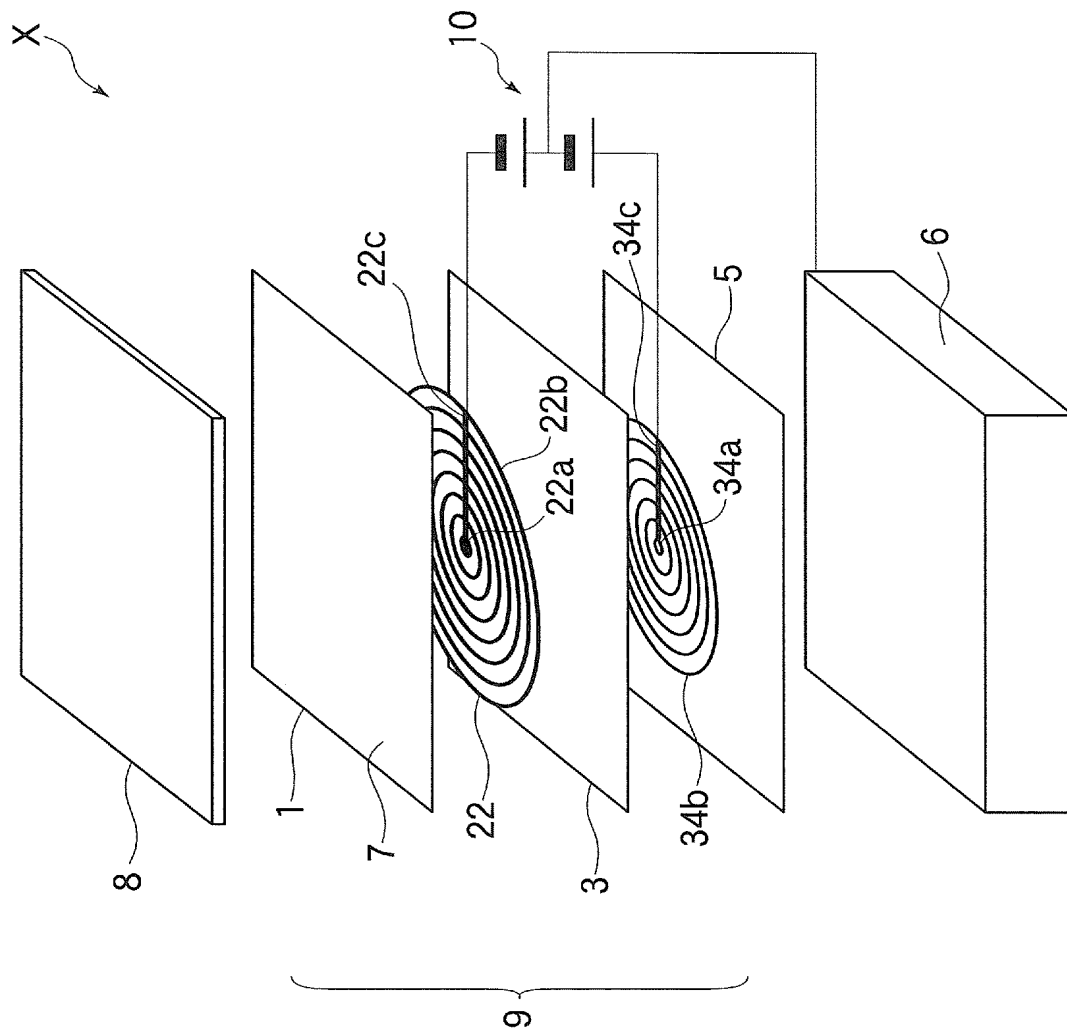
[図9]



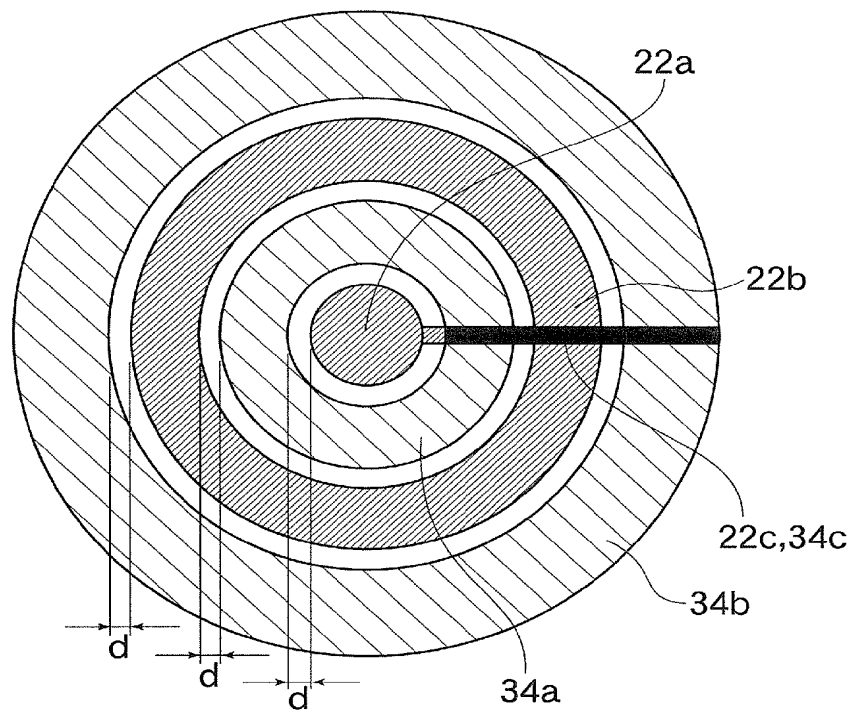
[[図10]]



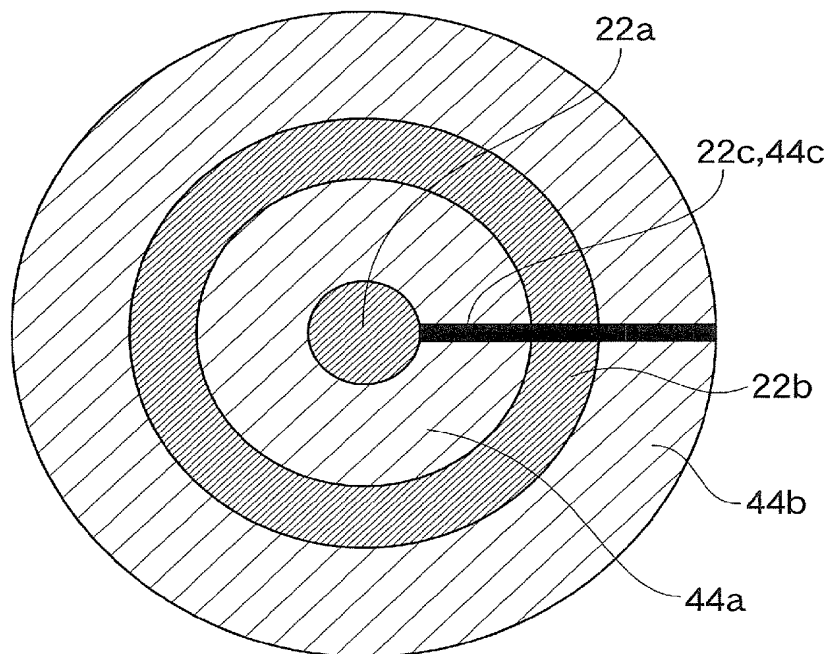
[図11]



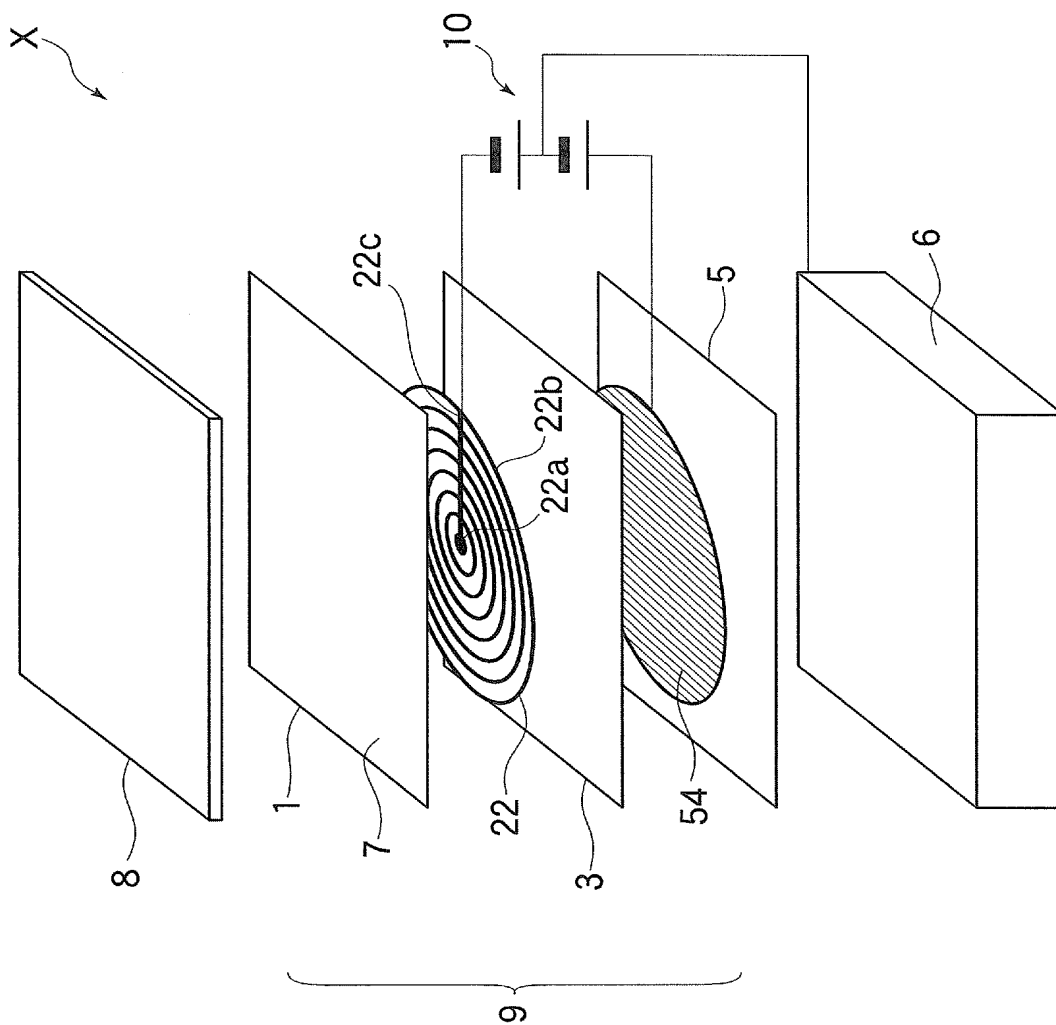
[[図12]]



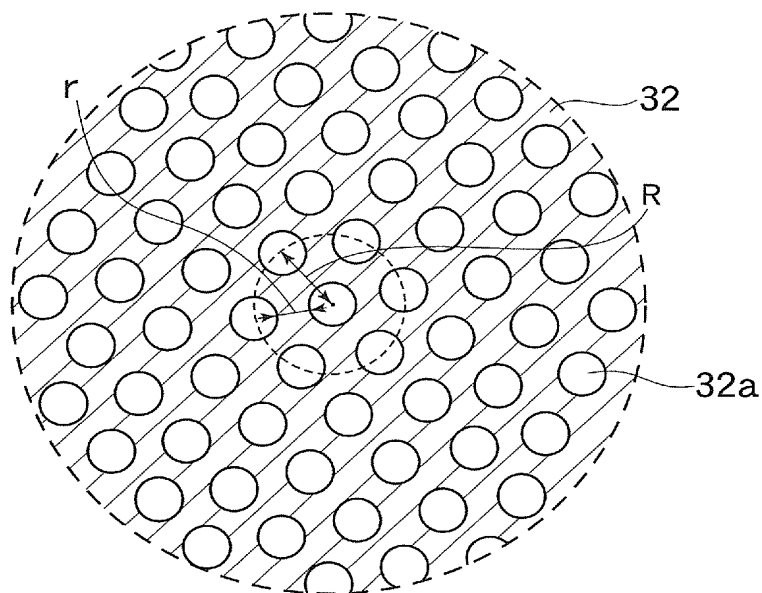
[[図13]]



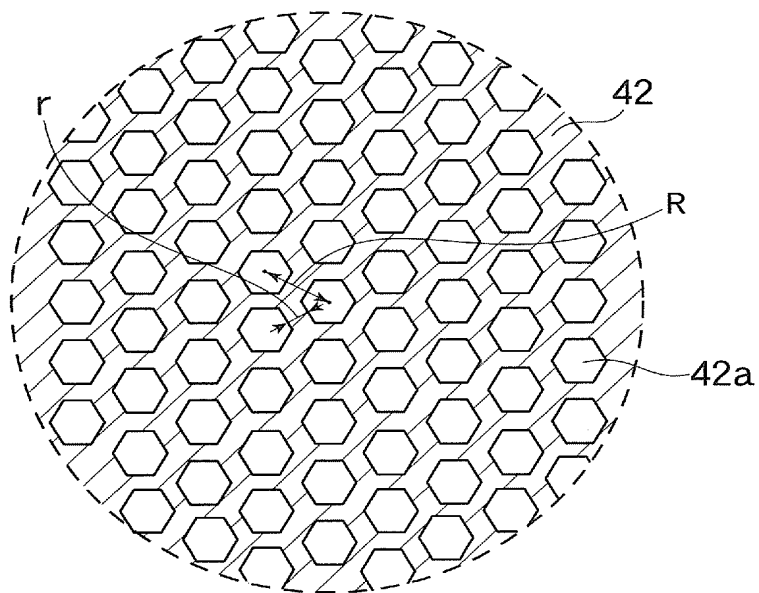
[図14]



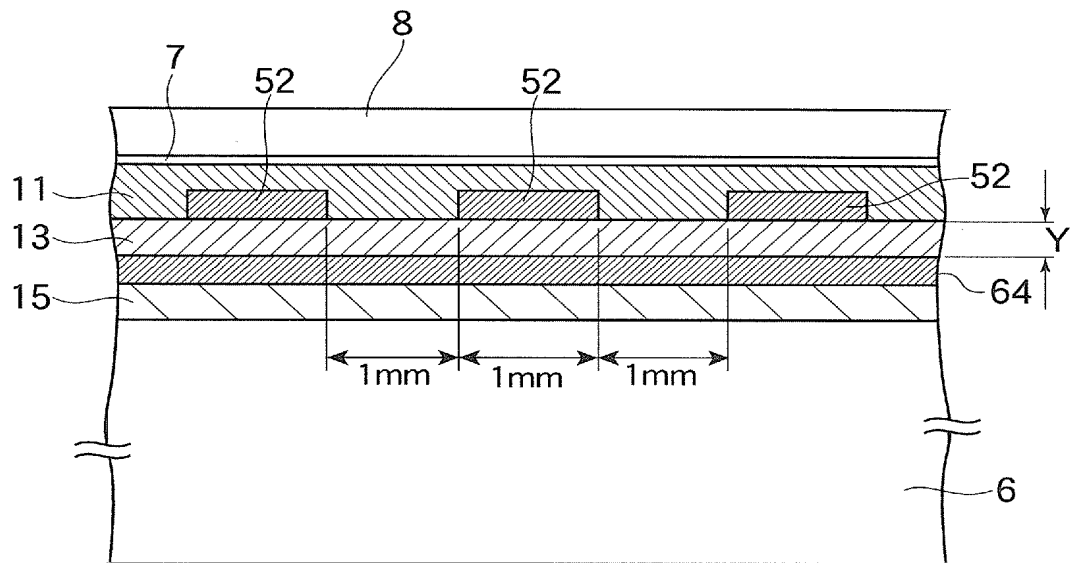
[[図15]]



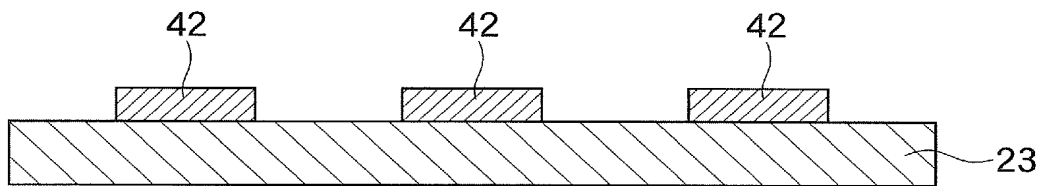
[[図16]]



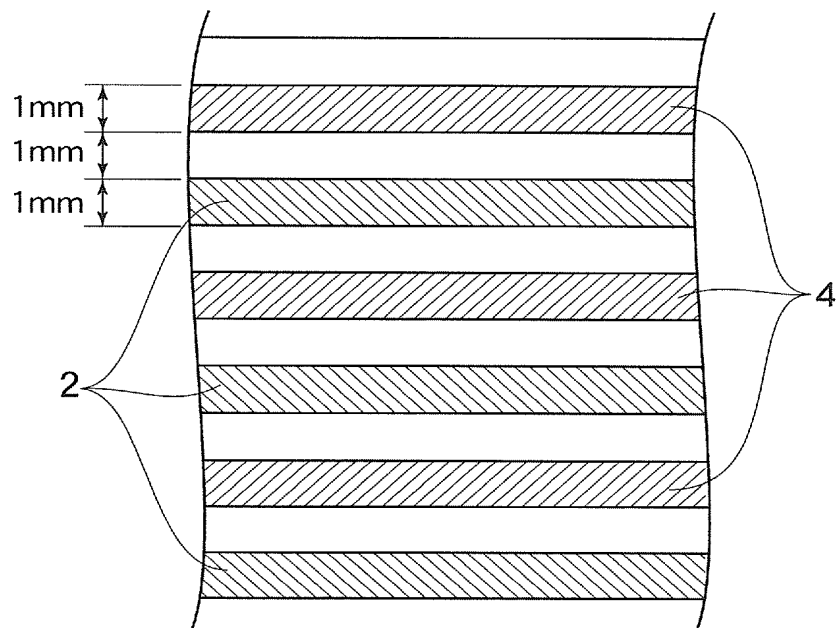
[図17]



[図18]

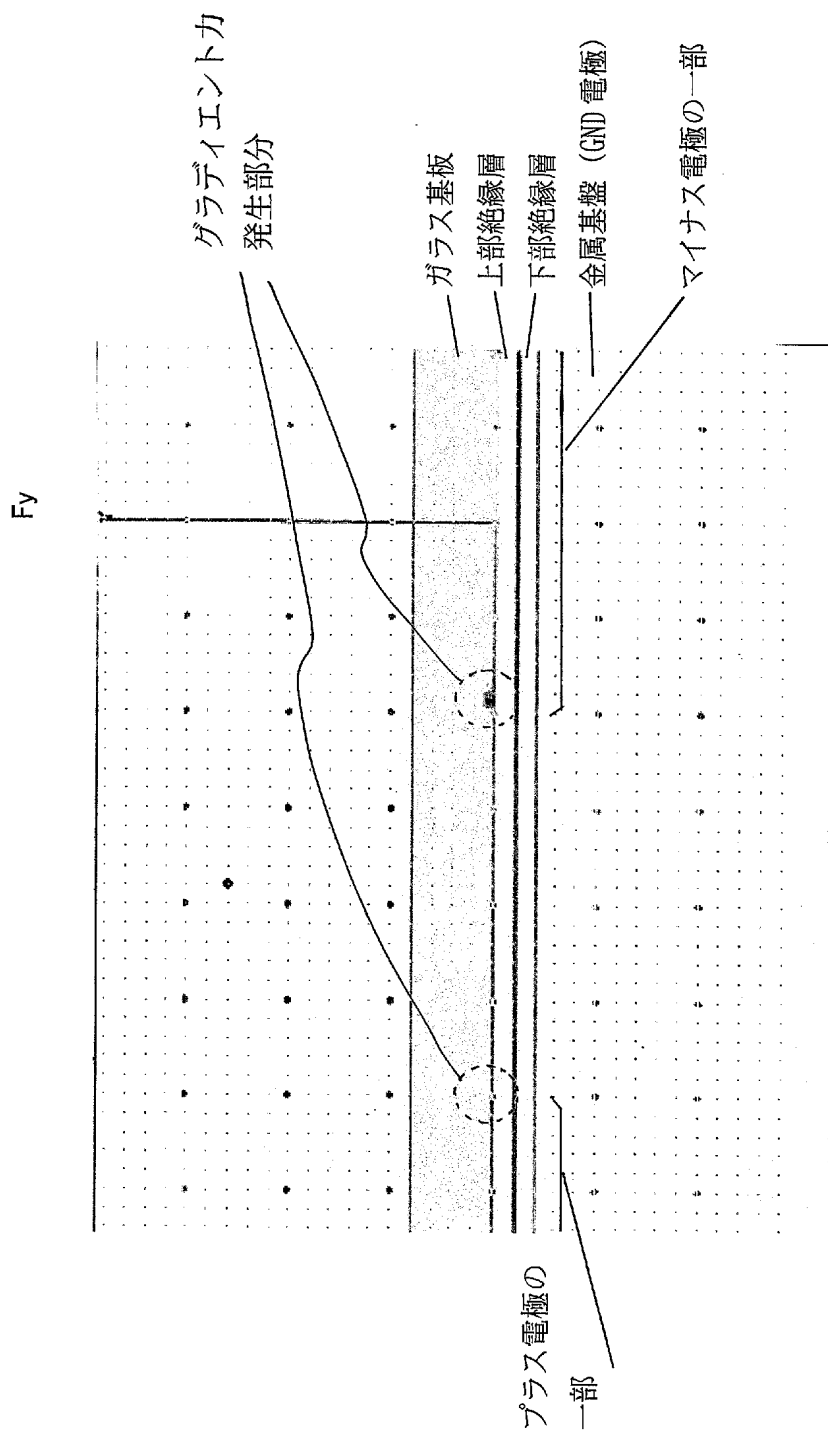


[図19]



[図20]

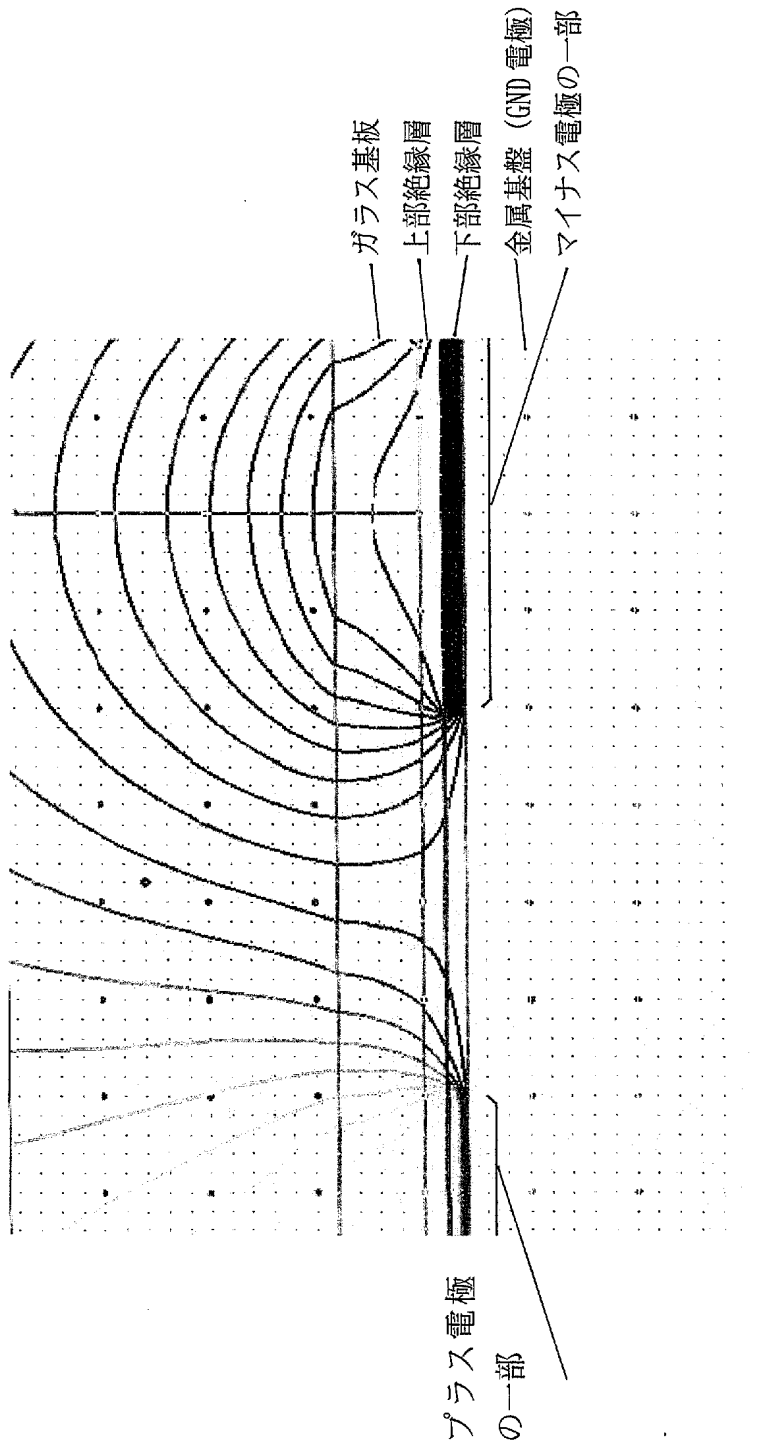
参考例1のグラディエントカの分布。濃い色のところが強い。



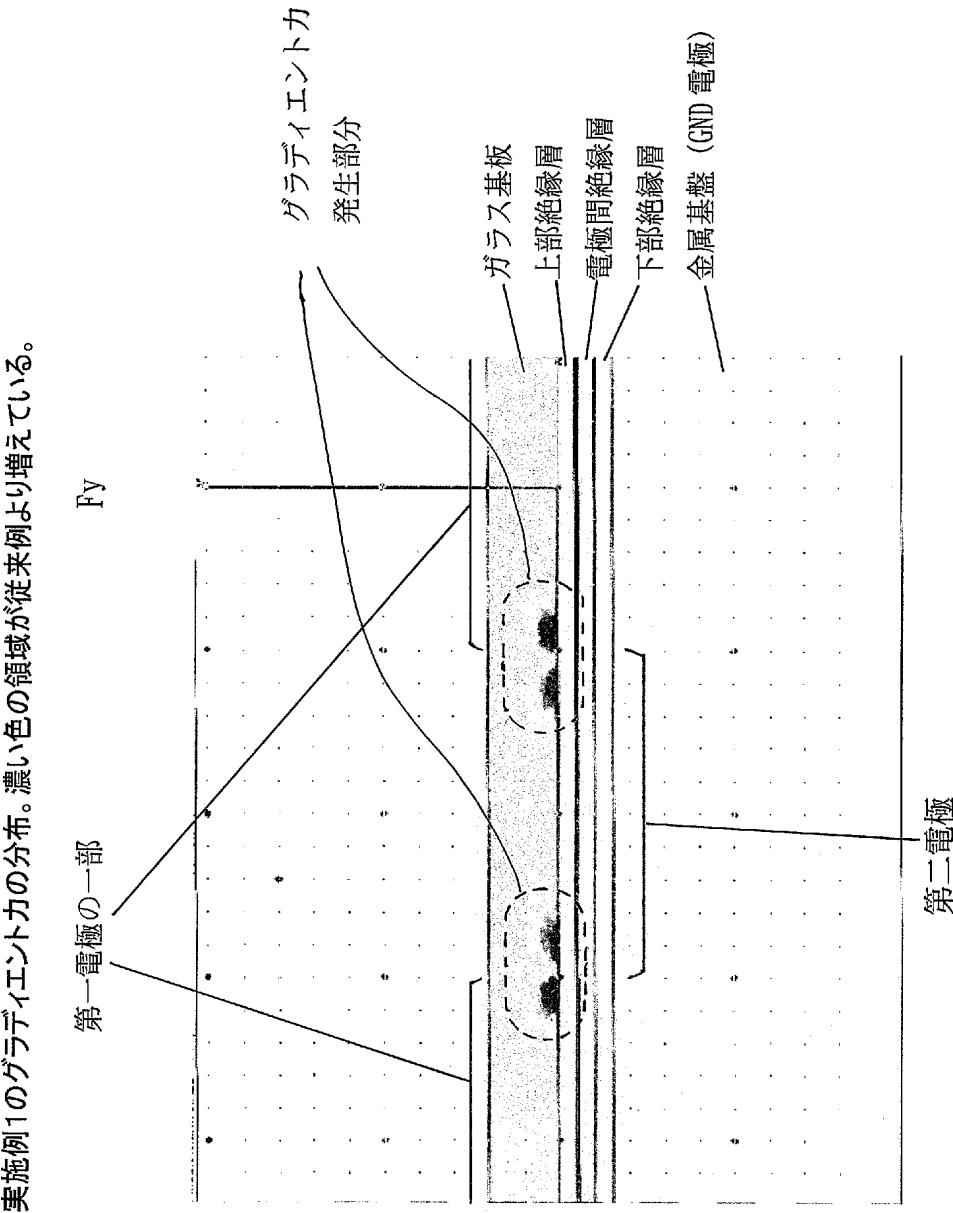
[図21]

参考例1の電位等高線図。線と線の間隔が狭いところは電界強度が強い。

Fy

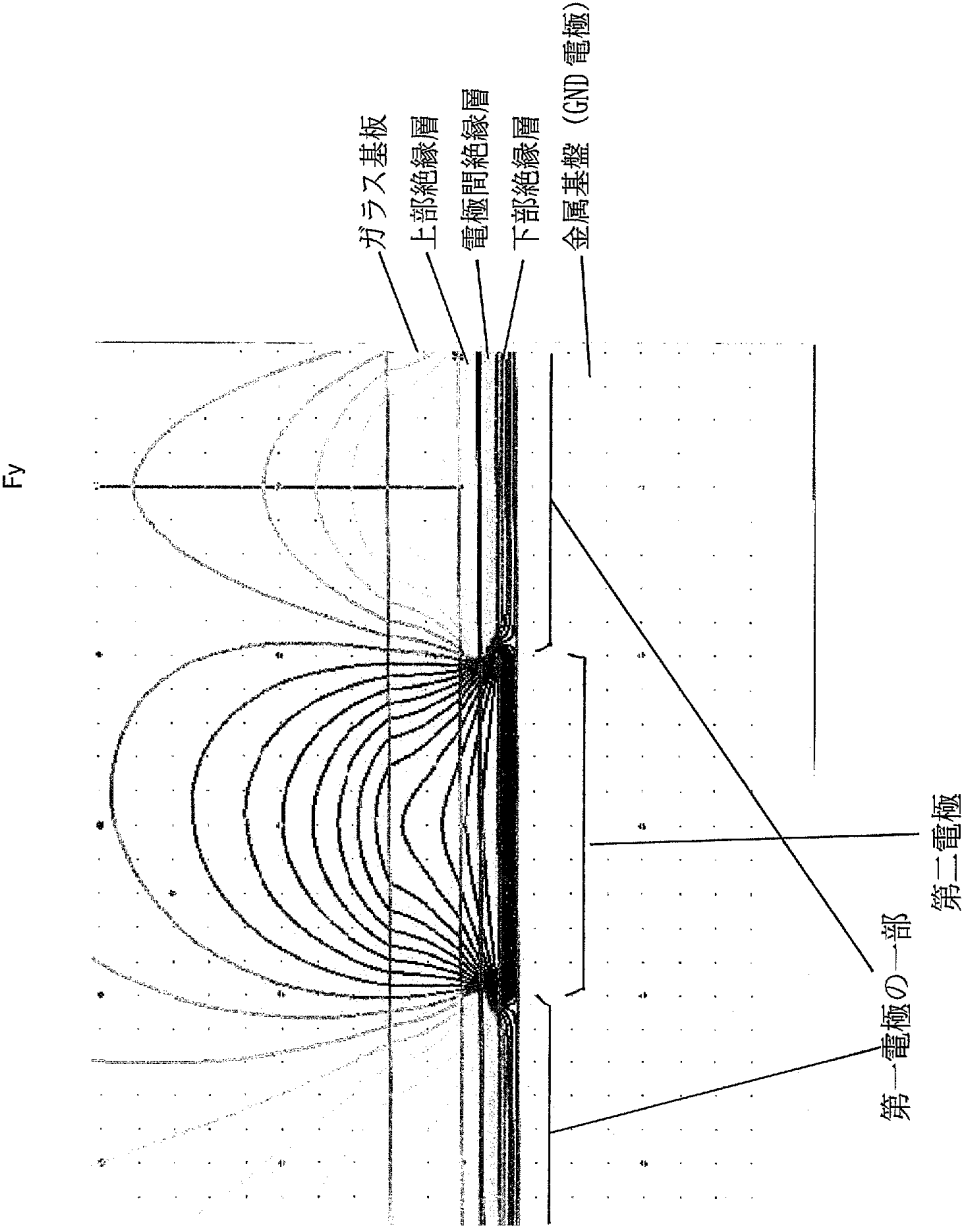


[図22]



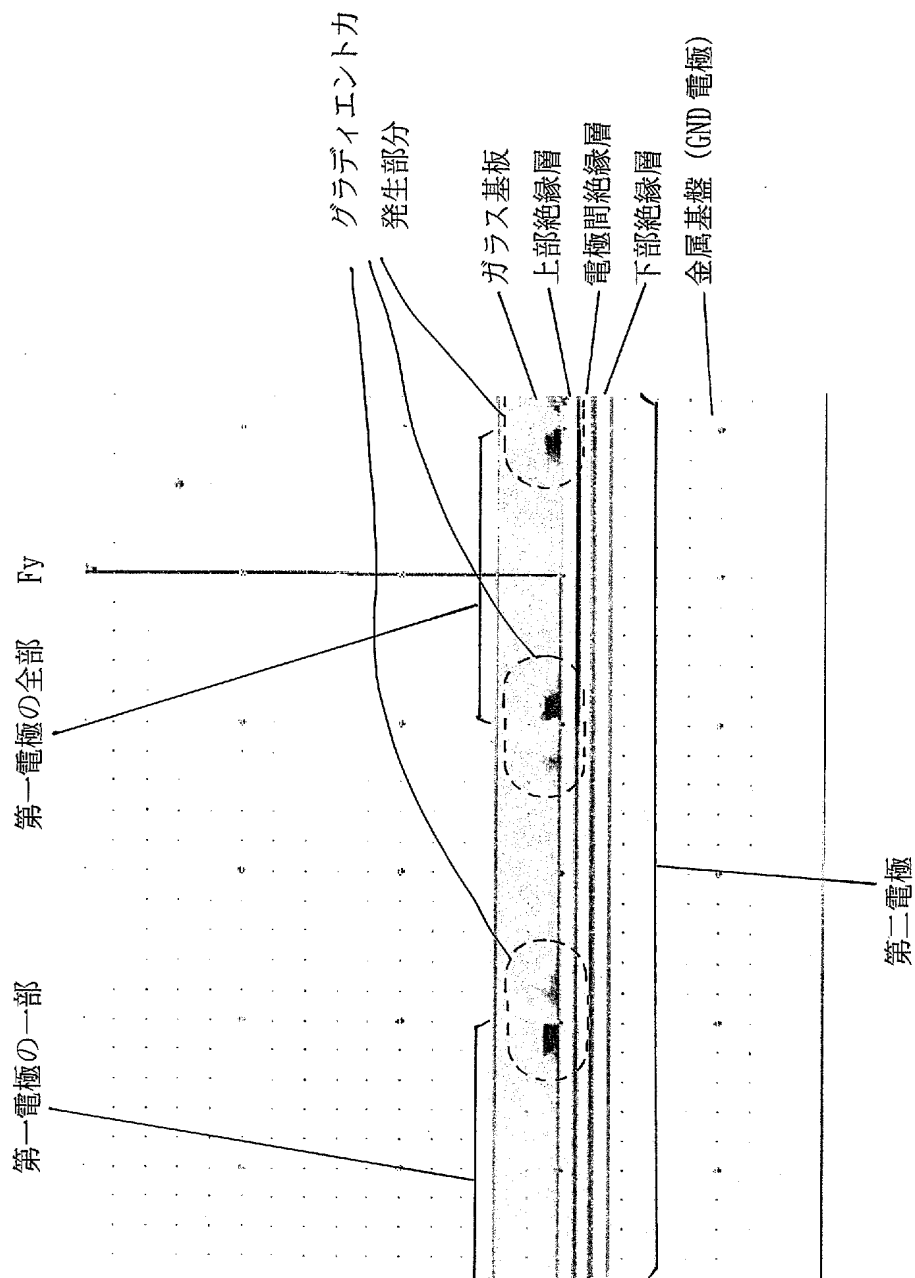
[図23]

実施例1の電位等高線図。線と線の間隔が狭いところが従来例に比べて増えている。



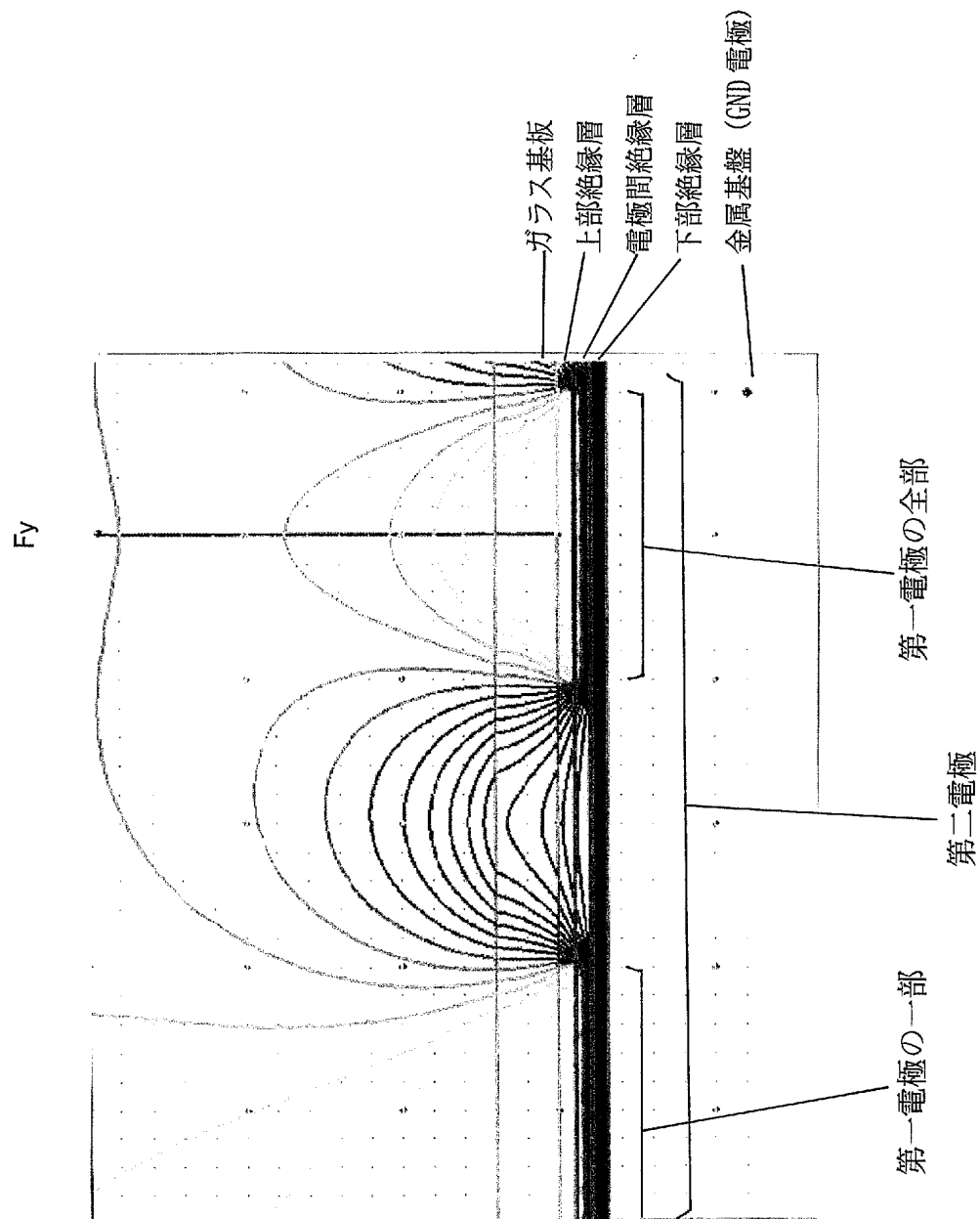
[図24]

実施例3のグラディエント力の分布。実施例1と同等の分布を示している。



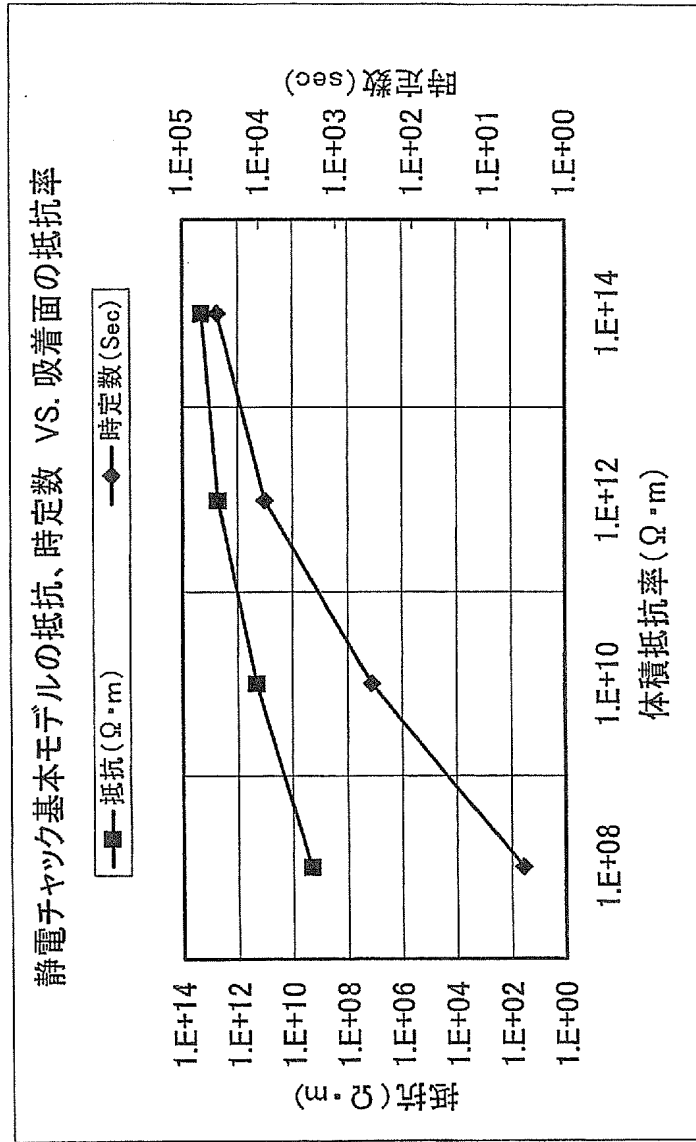
[図25]

実施例3の電位等高線図。実施例1とほぼ同様な分布を示す。

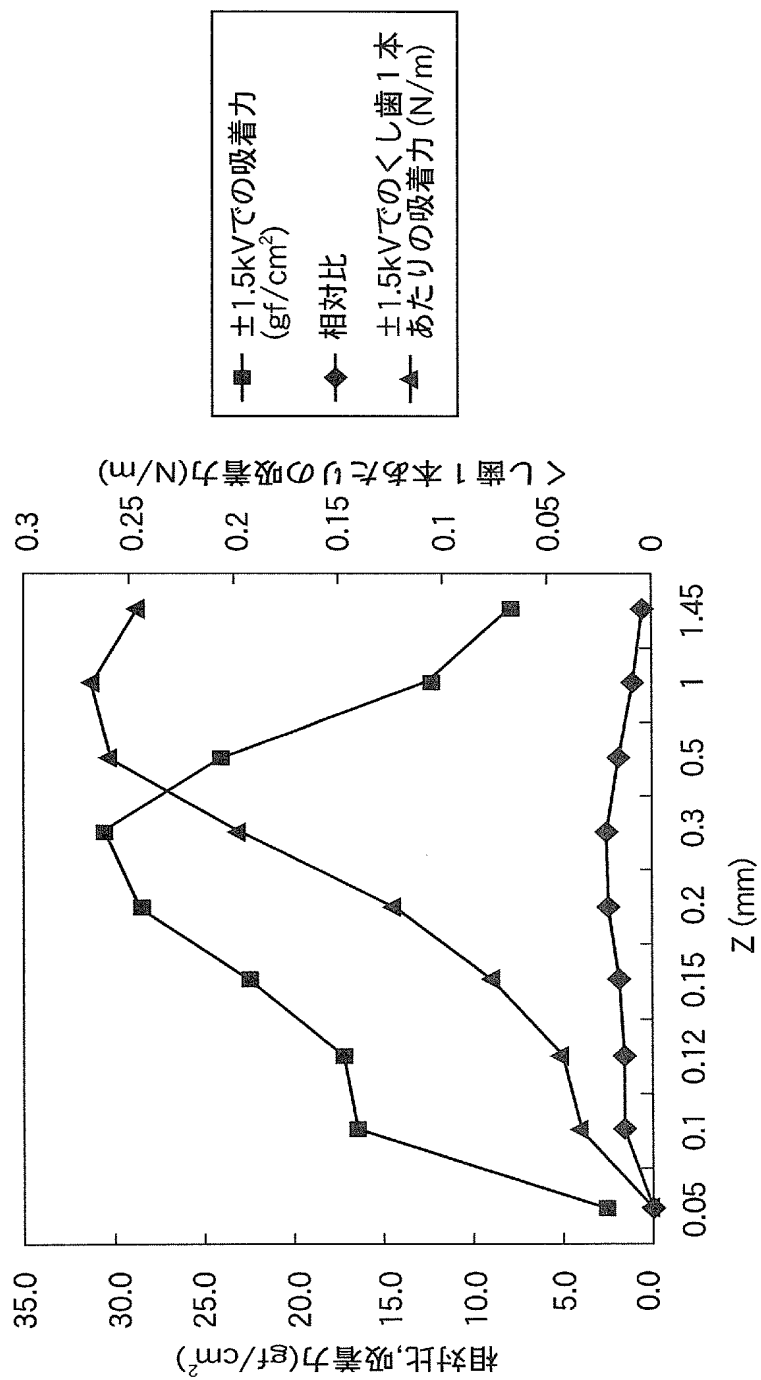


[図26]

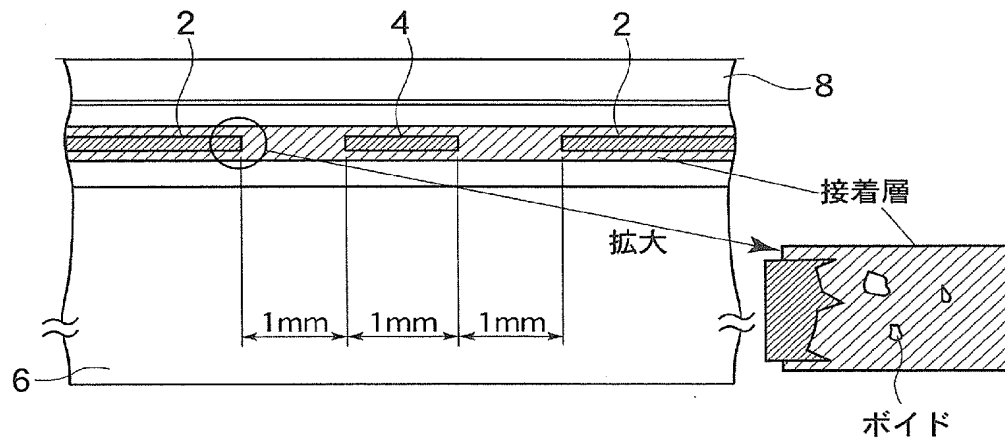
参考例1の静電チャックの上部絶縁層を導電性層としたときの時定数の変化。



[図27]



[図28]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/004557

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl.⁷ H01L21/68, H02N13/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.⁷ H01L21/68, H02N13/00, B23Q3/15

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y A	JP 6-302678 A (Tokyo Electron Ltd.), 28 October, 1994 (28.10.94), Full text; all drawings (Family: none)	1-3, 13, 20, 21 15-19 7, 8
X Y A	JP 2002-124446 A (Ibiden Co., Ltd.), 26 April, 2002 (26.04.02), Full text; all drawings & EP 1124404 A1 Full text; all drawings & US 2002/0043530 A1 & US 2003/0015521 A1 & WO 2001/039551 A1	1-3, 13, 17, 20, 21 4, 6, 14, 17-19 7, 8



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T"

later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&"

document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

13 June, 2005 (13.06.05)

Date of mailing of the international search report

28 June, 2005 (28.06.05)

Name and mailing address of the ISA/

Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/004557

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 8-203991 A (APPLIED MATERIALS, INC.), 09 August, 1996 (09.08.96),	1-3, 5, 13, 15, 16, 20, 21
Y	Full text; all drawings	4, 6, 9-12, 14-19
A	Full text; all drawings & EP 0692814 A1 & US 564814 A1	7, 8
X	JP 2002-26113 A (Toshiba Corp.), 25 January, 2002 (25.01.02),	1-3, 5, 13, 20, 21
Y	Full text; all drawings	6, 9-12, 14, 17-19
A	Full text; all drawings & US 2002/0006680 A1	7, 8
Y	JP 2003-179128 A (NGK Spark Plug Co., Ltd.), 27 June, 2003 (27.06.03), Full text; all drawings (Family: none)	9
Y	JP 2004-31594 A (Kyocera Corp.), 29 January, 2004 (29.01.04), Par. No. [0019]; Fig. 2 (Family: none)	10-12
Y	JP 2003-318251 A (Kyocera Corp.), 07 November, 2003 (07.11.03), Claims; Fig. 2 (Family: none)	18
Y	JP 2004-31599 A (Kyocera Corp.), 29 January, 2004 (29.01.04), Par. No. [0023]; Fig. 2 (Family: none)	18
Y	JP 8-64663 A (Sumitomo Metal Industries, Ltd.), 08 March, 1996 (08.03.96), Full text; all drawings (Family: none)	19
Y	JP 11-251417 A (Kyocera Corp.), 17 September, 1999 (17.09.99), Full text; all drawings (Family: none)	19

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.⁷ H01L21/68, H02N13/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.⁷ H01L21/68, H02N13/00, B23Q3/15

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 6-302678 A (東京エレクトロン株式会社) 1994. 10. 28, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-3, 13, 20, 21
Y		15-19
A		7, 8
X	JP 2002-124446 A (イビデン株式会社) 2002. 04. 26, 全文, 全図&EP 1124404 A1, 全文, 全図&US 2002/0043530 A1&US 2003/0015521 A1&W0	1-3, 13, 17, 20, 21

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

13. 06. 2005

国際調査報告の発送日

28. 6. 2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

中島 昭浩

電話番号 03-3581-1101 内線 3324

3U

9147

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	2001/039551 A1	4, 6, 14, 17-19
A		7, 8
X	J P 8-203991 A (アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド) 1996. 08. 09, 全文, 全図&EP 0692814 A1, 全文, 全図&US 5646814 A1	1-3, 5, 13, 15, 16, 20, 21
Y		4, 6, 9-12, 14-19
A		7, 8
X	J P 2002-26113 A (株式会社東芝) 2002. 01. 25, 全文, 全図&US 2002/0006680 A1, 全文, 全図	1-3, 5, 13, 20, 21
Y		6, 9-12, 14, 17-19
A		7, 8
Y	J P 2003-179128 A (日本特殊陶業株式会社) 2003. 06. 27, 全文, 全図 (ファミリーなし)	9
Y	J P 2004-31594 A (京セラ株式会社) 2004. 01. 29, 段落【0019】, 第2図 (ファミリーなし)	10-12
Y	J P 2003-318251 A (京セラ株式会社) 2003. 11. 07, 特許請求の範囲, 第2図 (ファミリーなし)	18
Y	J P 2004-31599 A (京セラ株式会社) 2004. 01. 29, 段落【0023】, 第2図 (ファミリーなし)	18
Y	J P 8-64663 A (住友金属工業株式会社) 1996. 03. 08, 全文, 全図 (ファミリーなし)	19
Y	J P 11-251417 A (京セラ株式会社) 1999. 09. 17, 全文, 全図 (ファミリーなし)	19